

2026年3月期第2四半期(2025年4月～9月) 決算説明資料

2025年11月11日
株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信に記載しております。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2026年3月期第2四半期連結決算概要

2026年3月期第2四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社2QはNAND向け装置販売とアップグレード改造の増加で増収増益。下期からの一部前倒しにより2Q累計では売上・利益とも前回予想を上回って着地。

2026年3月期連結業績予想・配当予想と今後の見通し

- 一部の半導体デバイスメーカーが設備投資の端境期にあったものの、AI関連用途を中心とした高性能デバイスの世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資は今後も続く見通し。
- 当社では、アップグレード改造(サービス)を含めた世界各国DRAM向けの売上が想定以上に好調ながら、下期に想定していた一部装置の販売が27/3期にずれ込む見通しとなり、売上・利益予想を修正。配当予想は据え置き。

連結業績サマリー

2Qは前年同期比・直前四半期比ともに増収増益。2Q累計は、前年同期の売上を上回ったものの、製品構成の変化や将来に向けた先行投資の影響により各利益は前年同期比で減少。前回予想比では、下期を想定していた装置販売の一部に前倒しがあり売上・利益とも上振れ。

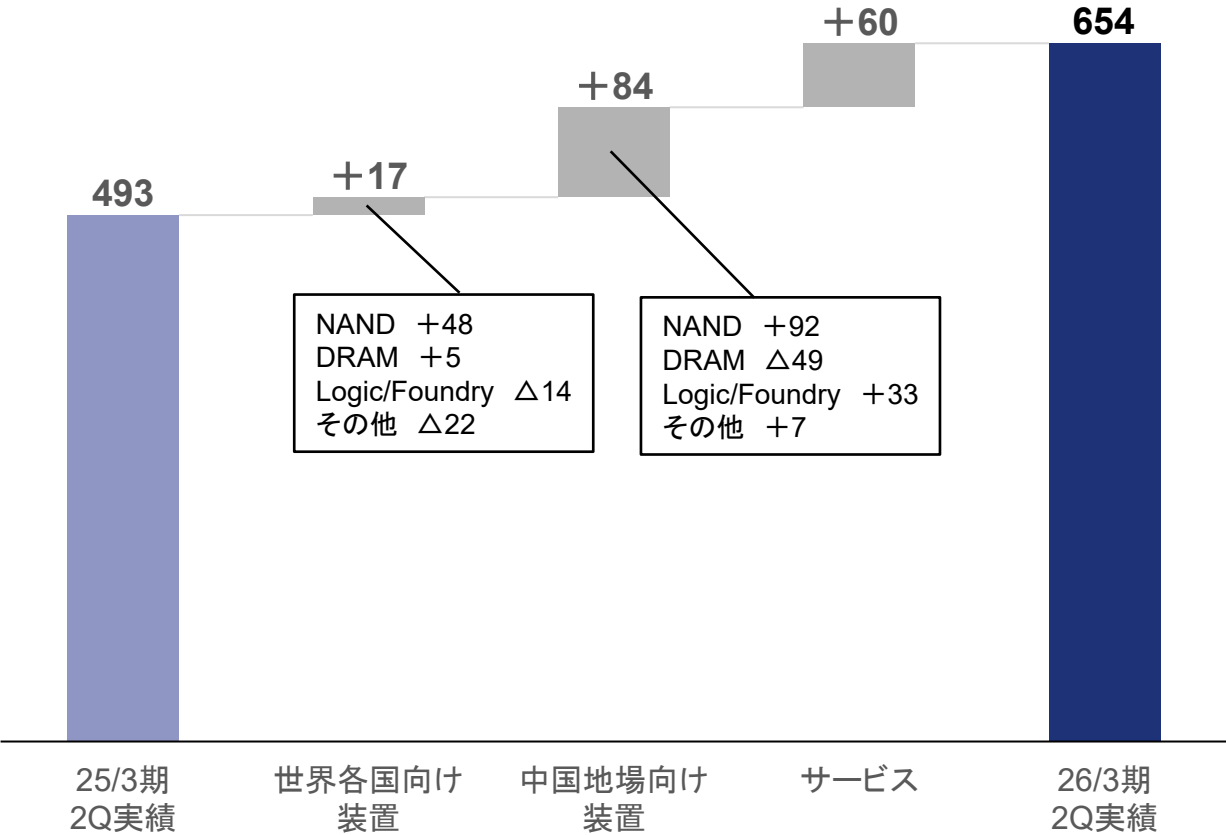
(億円)	25/3期			26/3期							
	1Q	2Q	2Q累計	1Q	2Q	前年同期比	前四半期比	2Q累計	前年同期比	2Q累計 前回予想比	2Q累計 前回予想
売上収益	652	493	1,145	518	654	+ 32.6%	+ 26.3%	1,172	+ 2.3%	+ 12.7%	1,040
売上総利益	294	220	514	222	273	+ 23.9%	+ 22.8%	495	△ 3.6%	+ 12.2%	441
売上総利益率	45.0%	44.6%	44.8%	42.9%	41.7%	△ 2.9pts	△ 1.2pts	42.2%	△ 2.6pts	△ 0.1pts	42.3%
調整後営業利益	194	113	307	109	144	+ 27.8%	+ 32.4%	253	△ 17.4%	+ 26.7%	200
調整後営業利益率	29.7%	22.9%	26.8%	21.1%	22.1%	△ 0.8pts	+ 1.0pts	21.6%	△ 5.2pts	+ 2.4pts	19.2%
調整後当期(四半期)利益	143	73	216	76	98	+ 34.7%	+ 28.8%	174	△ 19.5%	+ 24.2%	140
調整後当期(四半期)利益率	22.0%	14.7%	18.9%	14.7%	15.0%	+ 0.3pts	+ 0.3pts	14.8%	△ 4.1pts	+ 1.3pts	13.5%
営業利益	179	96	274	97	130	+ 35.9%	+ 33.7%	227	△ 17.2%	+ 33.6%	170
営業利益率	27.4%	19.4%	24.0%	18.8%	19.9%	+ 0.5pts	+ 1.1pts	19.4%	△ 4.6pts	+ 3.1pts	16.3%
税引前当期(四半期)利益	177	102	279	93	128	+ 25.9%	+ 37.7%	222	△ 20.7%	+ 34.3%	165
税引前当期(四半期)利益率	27.2%	20.7%	24.4%	18.0%	19.6%	△ 1.1pts	+ 1.6pts	18.9%	△ 5.5pts	+ 3.1pts	15.9%
当期(四半期)利益	133	48	181	68	88	+ 84.8%	+ 29.6%	156	△ 13.8%	+ 30.7%	119
当期(四半期)利益率	20.4%	9.6%	15.8%	13.1%	13.4%	+ 3.8pts	+ 0.3pts	13.3%	△ 2.5pts	+ 1.8pts	11.4%
研究開発費	33	39	73	39	48	+ 23.0%	+ 25.2%	87	+ 19.3%	-	-
設備投資額	112	30	142	23	52	+ 72.7%	+ 126.2%	75	△ 47.2%	-	-
減価償却費	29	30	59	34	35	+ 15.6%	+ 2.4%	69	+ 16.4%	-	-
1株当たり配当金(円)	-	18	18	-	18	-	-	18	± 0%	18	18

2026年3月期第2四半期実績 増減要因

2Qは、中国地場向け装置、サービスの売上が伸長し、全体の売上収益は前年同期比33%増。
販売等の増加による売上総利益の増加が製品構成の変化による売上総利益率低下と販管費増加を吸収し、調整後営業利益は前年同期比28%増。

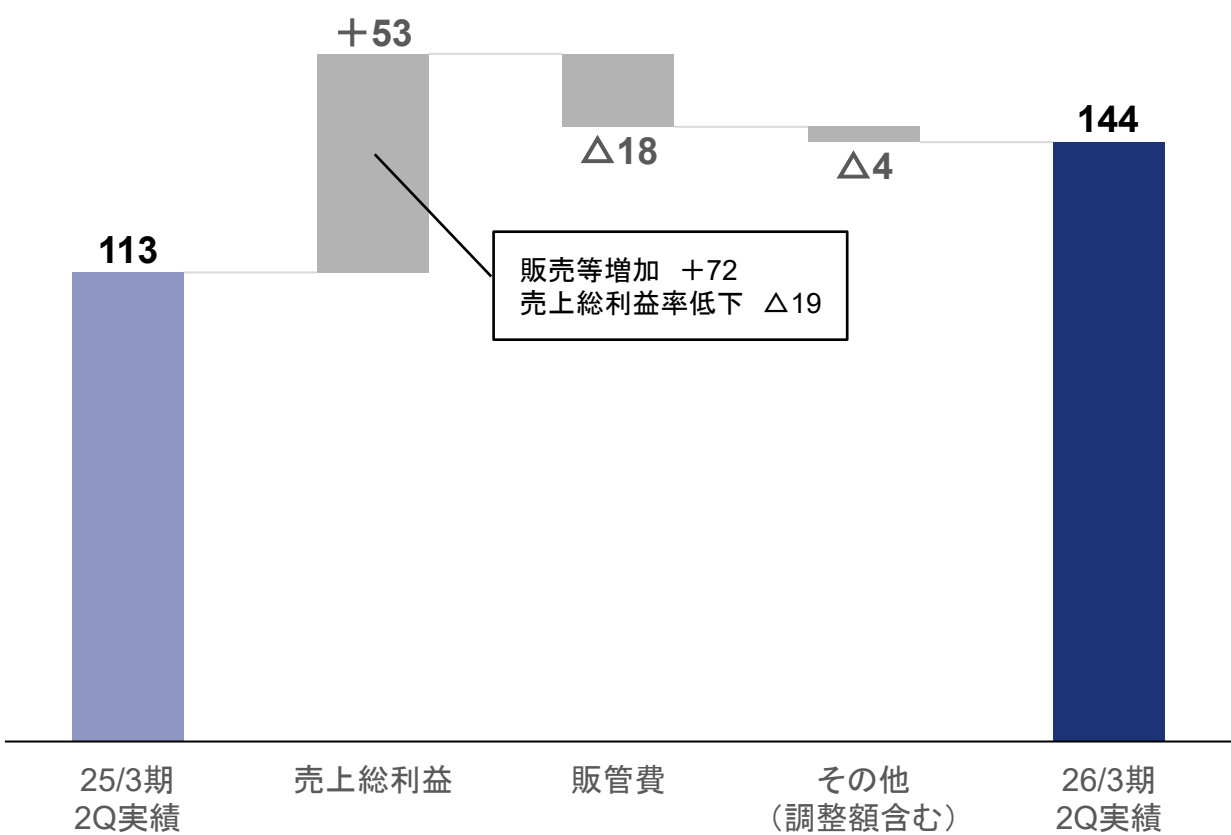
売上収益

(億円)



調整後営業利益

(億円)

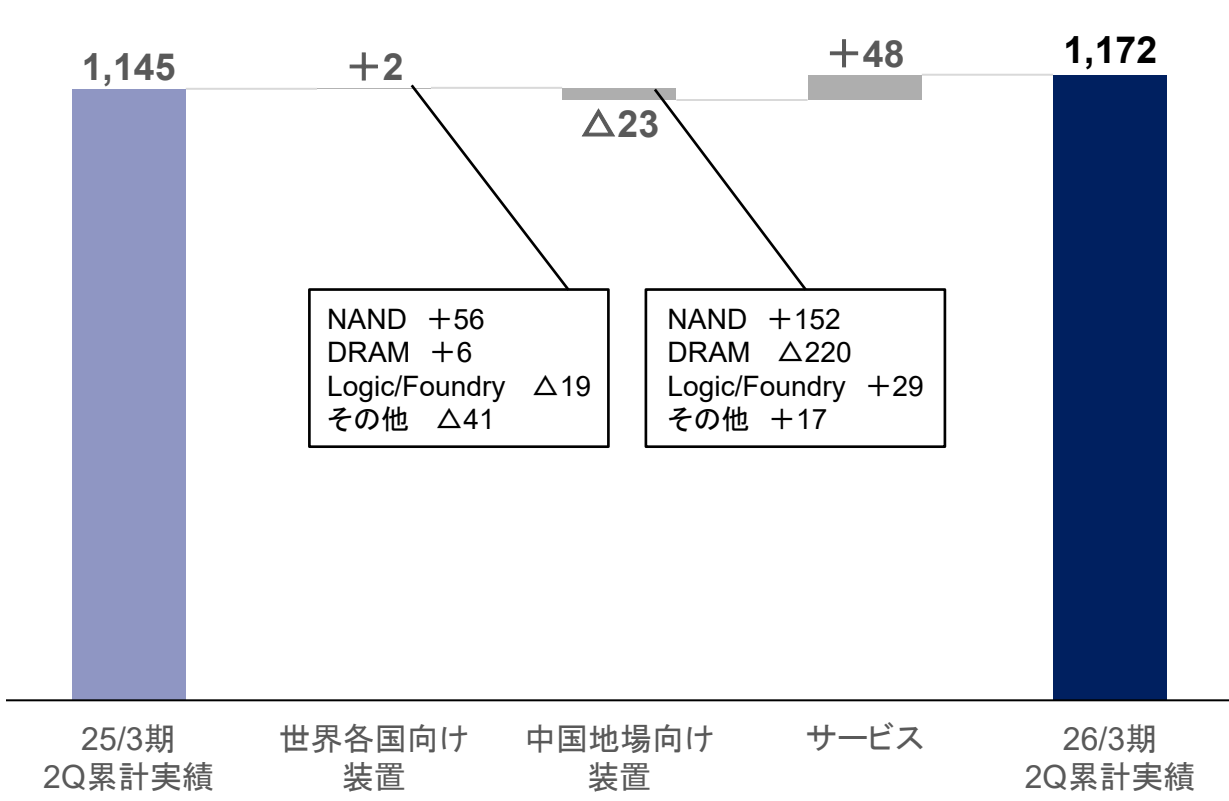


2026年3月期第2四半期(累計)実績 増減要因

2Q累計では、前年同期に集中した出荷が落ち着いた影響で中国地場向け装置売上が減少したものの、販売済み装置のアップグレード改造(サービス)が伸長し、全体の売上収益は前年同期比2%増。
製品構成の変化による売上総利益率低下、販管費の増加により、調整後営業利益は前年同期比17%減。

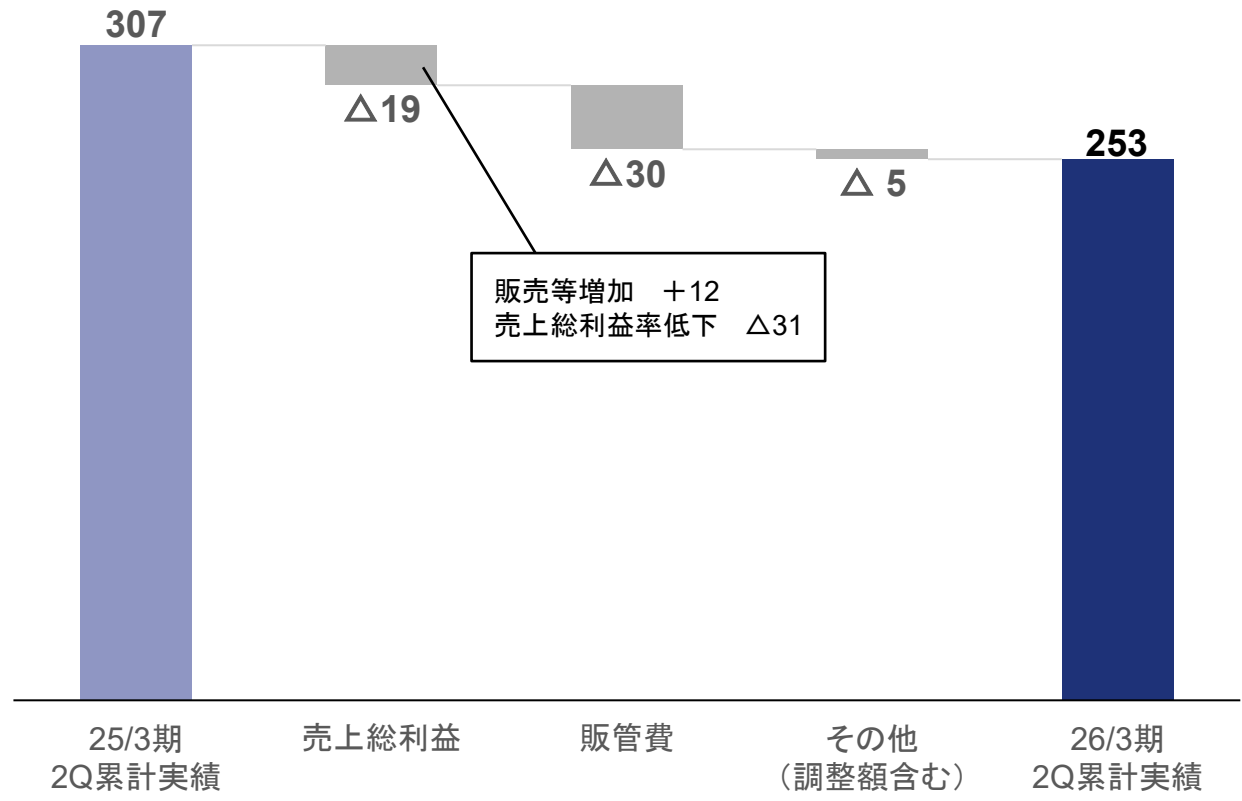
売上収益

(億円)



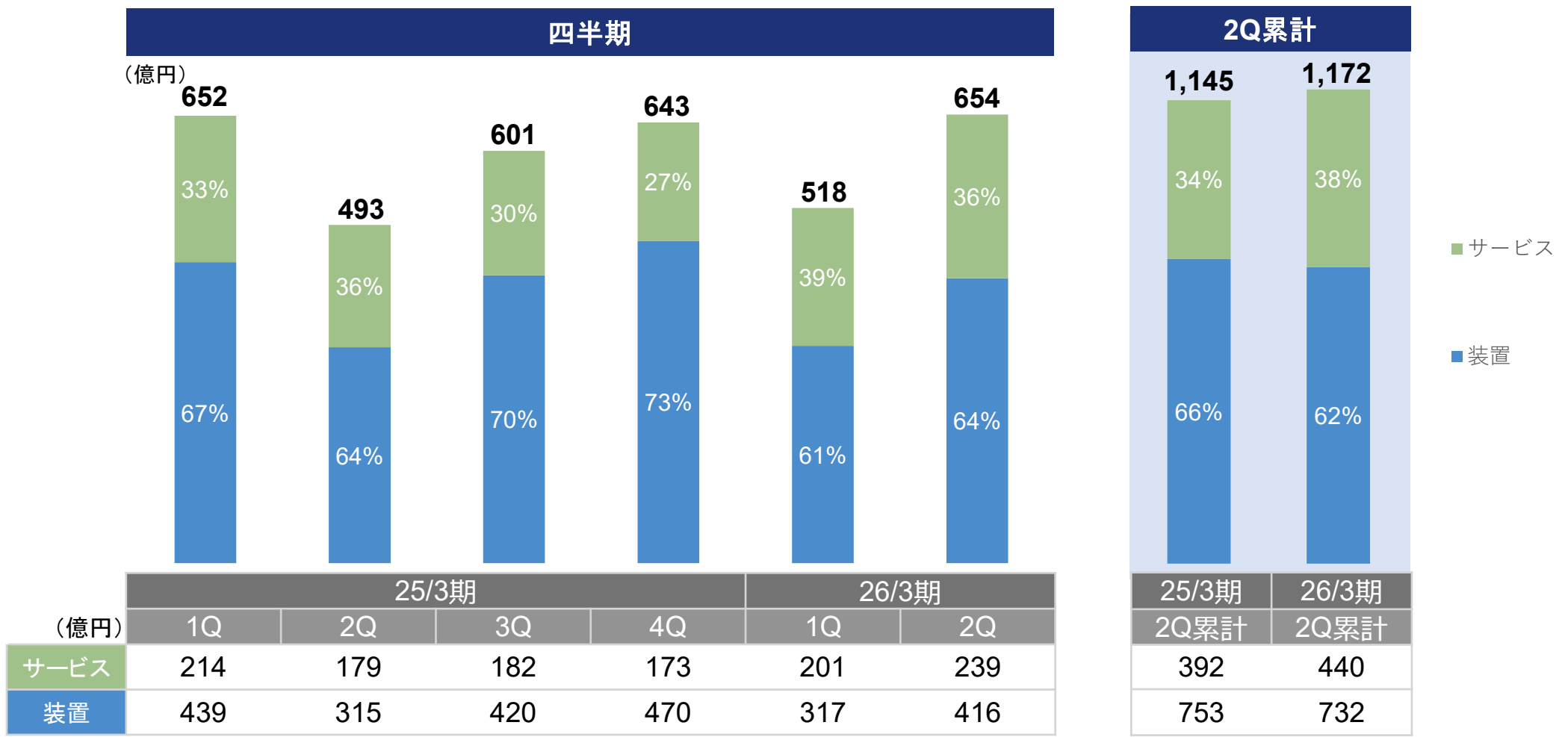
調整後営業利益

(億円)



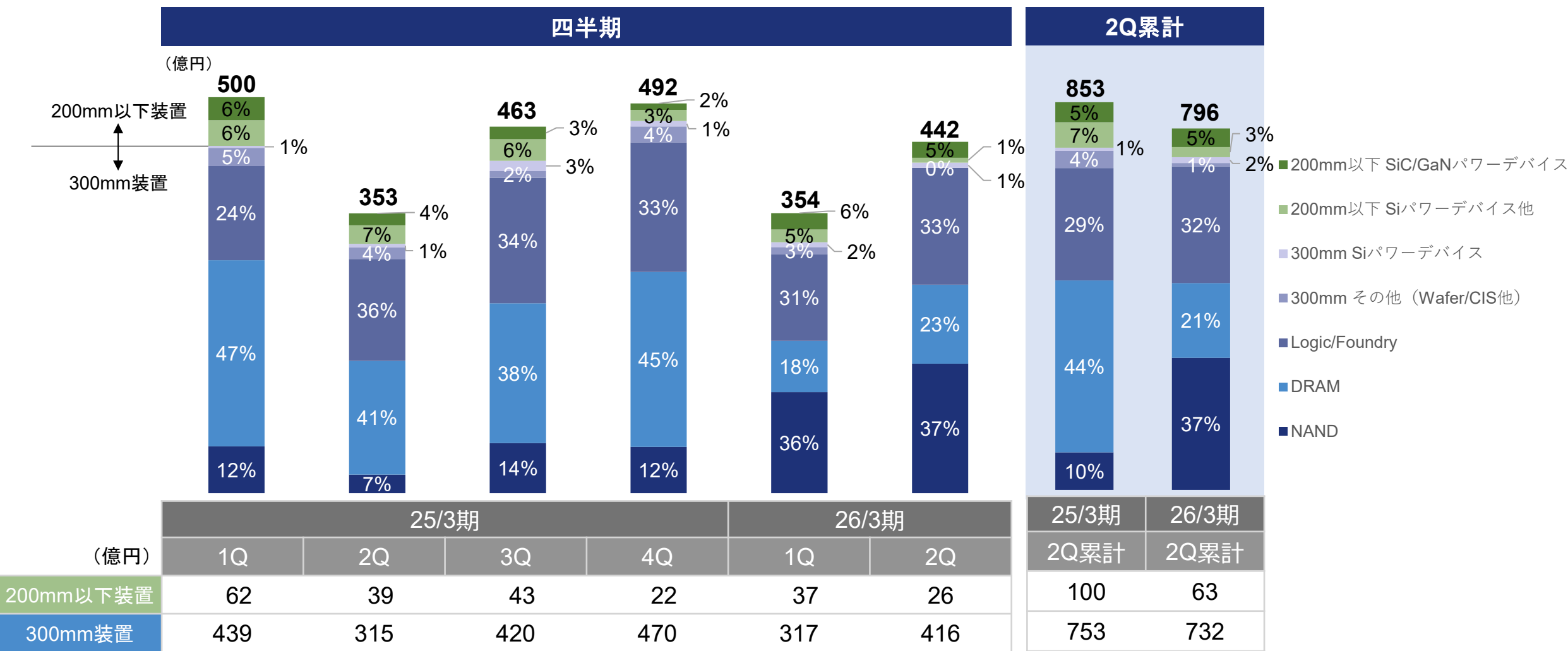
四半期別売上収益 ビジネス別

2Qは、前年同期比で装置売上が32%、サービス売上が34%の増加。直前四半期比では装置売上が31%、サービス売上が19%の増加。2Q累計は、新規装置販売に代えてアップグレード改造(サービス)が増加した影響により、前年同期比で装置売上3%減、サービス売上12%増加。



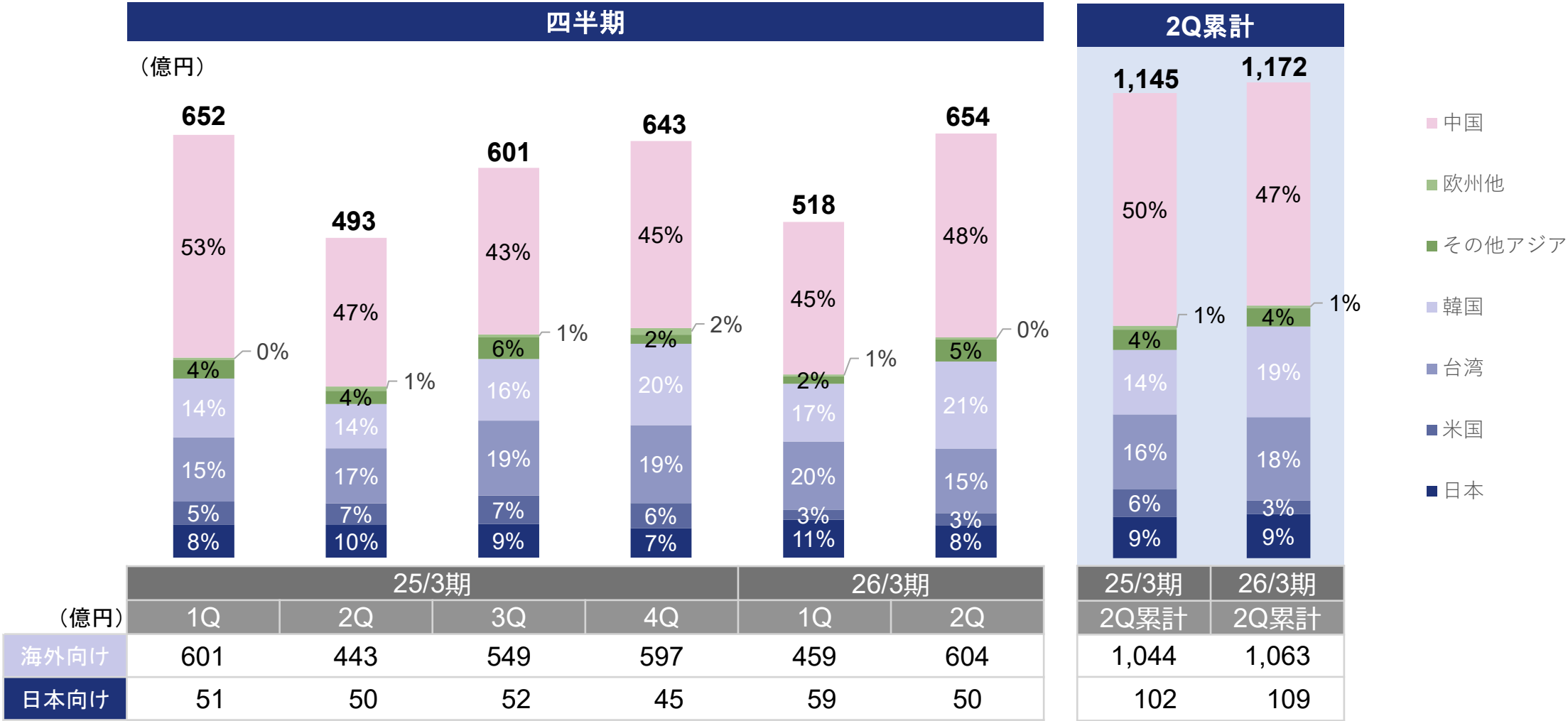
四半期別売上収益 アプリケーション別(300mm装置+200mm以下装置)

2Q、2Q累計とも、前年同期比でNAND、Logic/Foundry向けが増加。DRAM向けは一部がアップグレード改造(サービス)に置き換わり減少。直前四半期比ではNAND、DRAM、Logic/Foundry向けともに増加。



四半期別売上収益 仕向地別

2Qは、前年同期比で韓国向け、中国向けが増加。米国向けは減少。
2Q累計では、韓国向け、台湾向けが増加。米国向け売上比率は3%、中国向け売上比率は47%に低下。



2Q累計

1,145

50%

4%

1%

14%

16%

6%

9%

1,172

47%

4%

1%

19%

18%

3%

9%

25/3期

26/3期

2Q累計

2Q累計

1,044

1,063

102

109

中国

欧州他

その他アジア

韓国

台湾

米国

日本

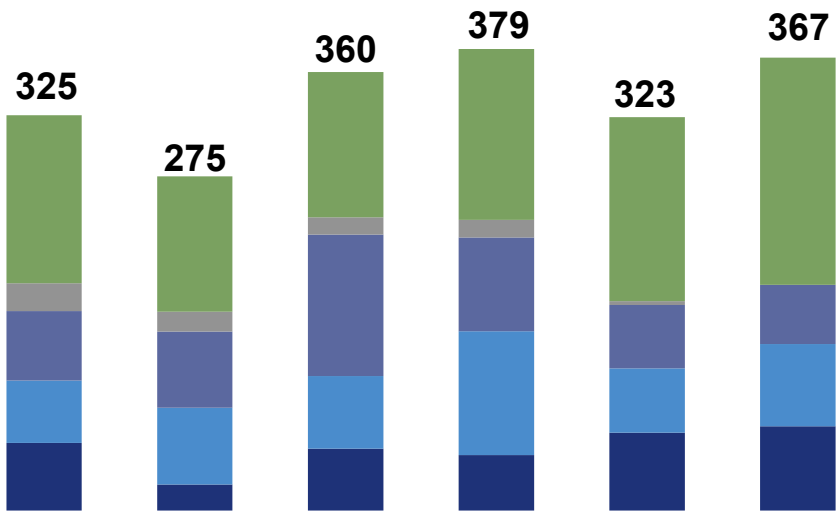
四半期別売上収益 アカウント別*1

2Qの世界各国向け売上は、デバイスメーカーの積極投資により、直前四半期比でNAND、DRAM向け、アップグレード改造(サービス)が伸長。

2Qの中国地場向け売上は、直前四半期比でNAND、Logic/Foundry向けが増加し、DRAM向けも端境期から増加に転換。中国地場売上比率は一時的に上昇し、44%。

世界各国向け売上収益

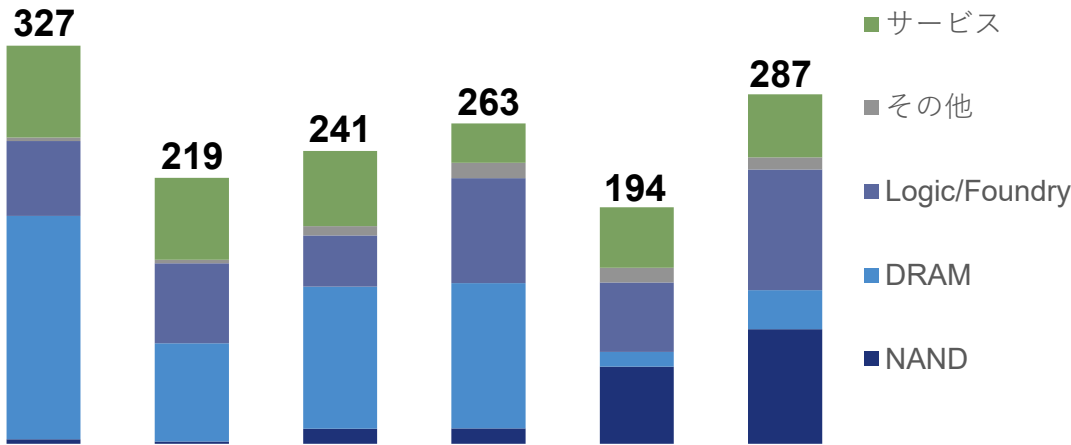
(億円)



	25/3期				26/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
世界各国比率	50%	56%	60%	59%	62%	56%

中国地場向け売上収益

(億円)



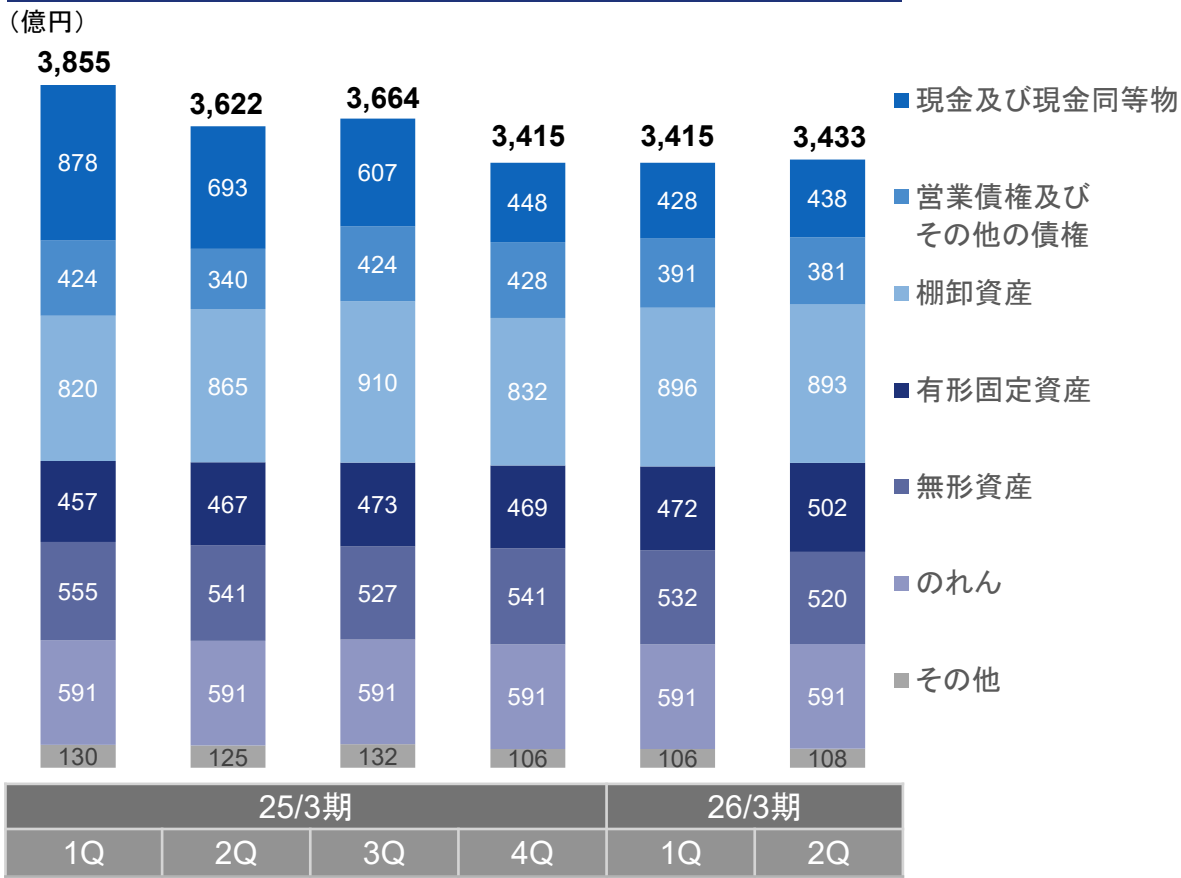
	25/3期				26/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
中国地場比率	50%	44%	40%	41%	38%	44%

*1 世界各国デバイスメーカー(中国以外に本拠のあるメーカー)向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

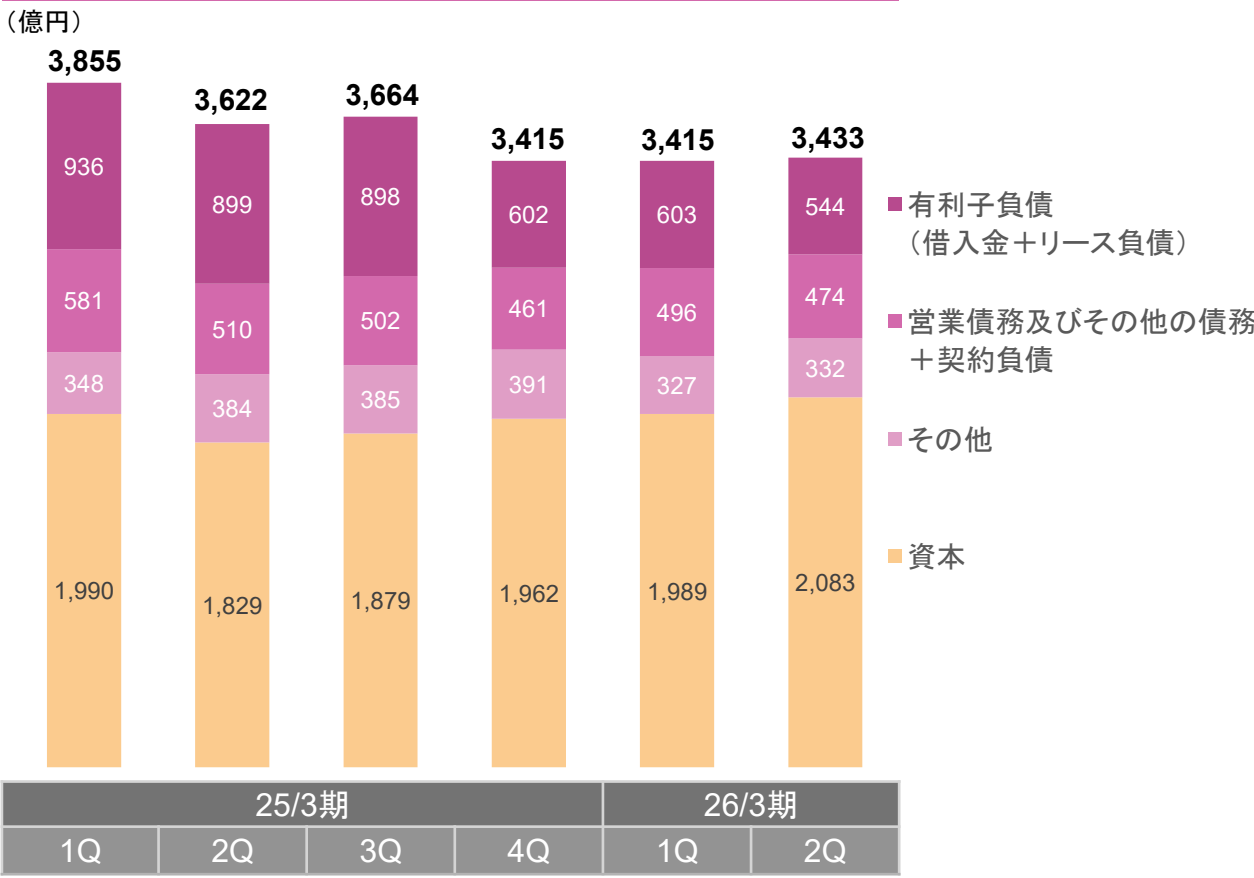
四半期別貸借対照表

2Q末の資産合計は、営業債権及びその他の債権等が減少したものの、棚卸資産の増加、米国デモセンター設立に伴う投資等により有形固定資産は増加し、25年3月期末比で18億円増加。資本合計は、利益剰余金の増加等により25年3月期末比で121億円増加。

資産

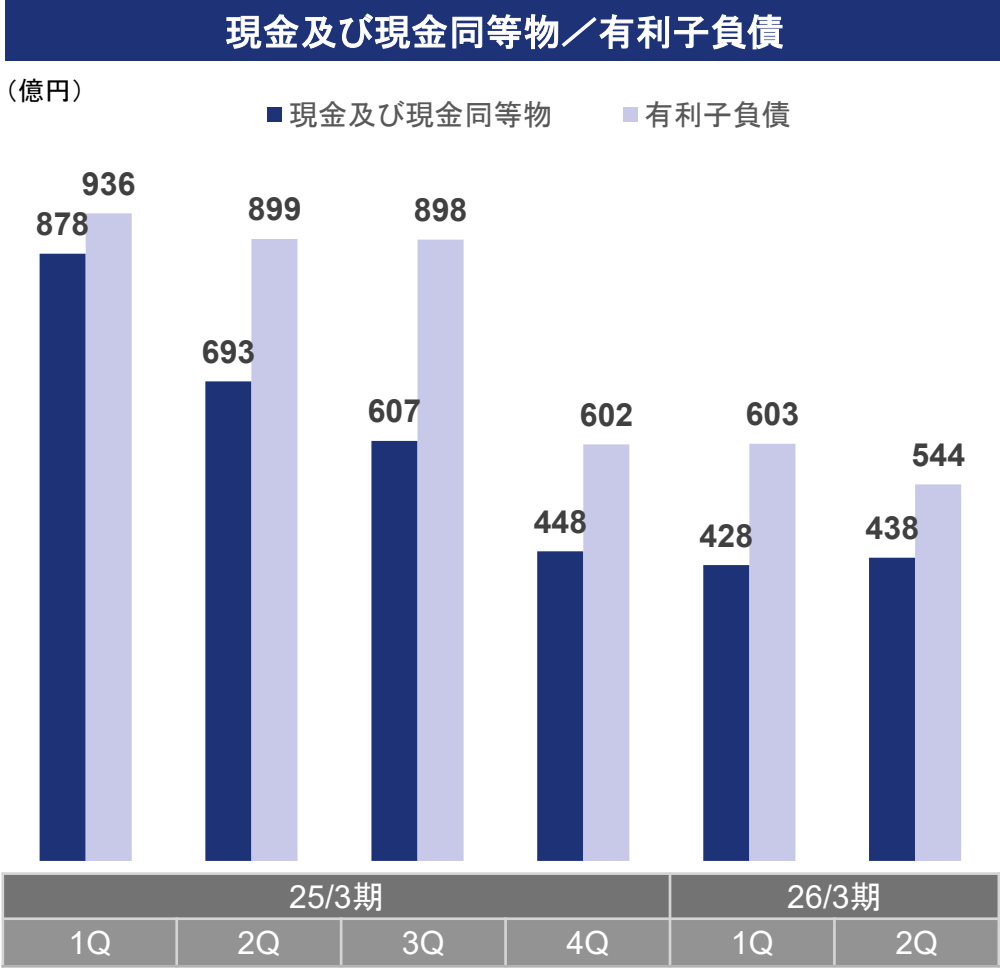


負債／資本



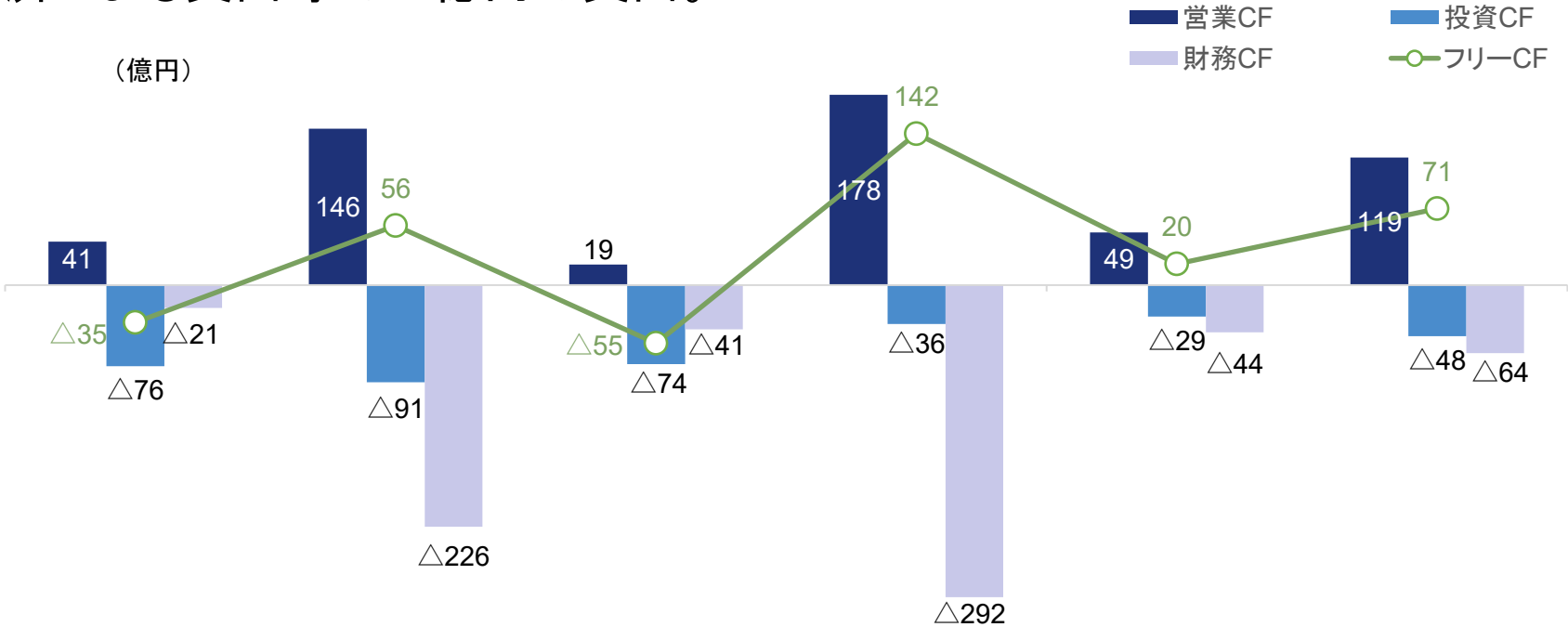
四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

2Q末の自己資本比率は、直前四半期末比で2.5ポイント増加し、60.7%。
2Q末のネットデットは、概ね計画通り106億円。



四半期別キャッシュ・フロー

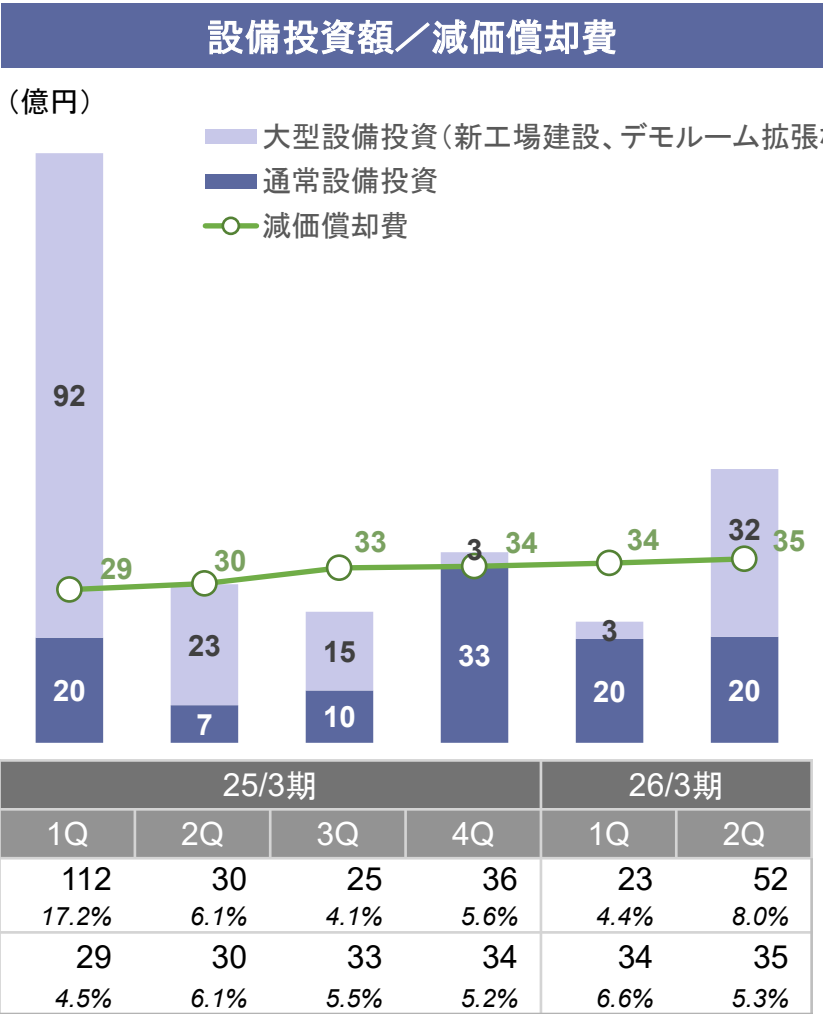
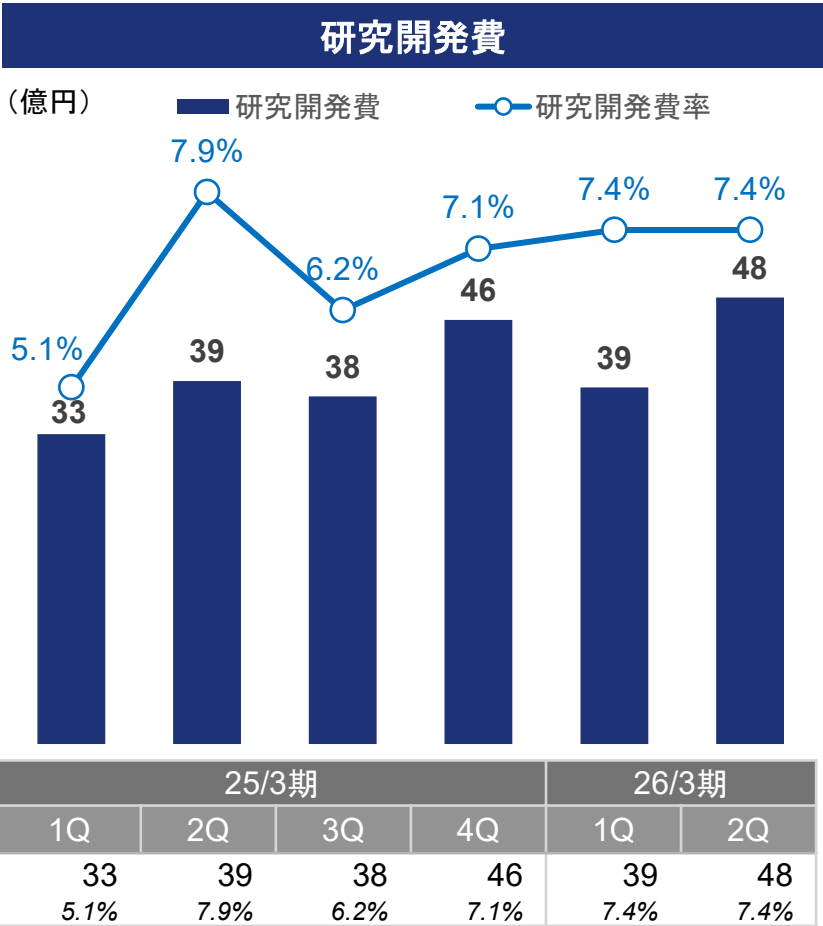
2Qは、営業CFが投資CFを上回り、フリーCFは71億円の収入。
財務CFは、借入金の返済による支出等で64億円の支出。



(億円)	25/3期				26/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業CF	+ 41	+ 146	+ 19	+ 178	+ 49	+ 119
投資CF	△ 76	△ 91	△ 74	△ 36	△ 29	△ 48
財務CF	△ 21	△ 226	△ 41	△ 292	△ 44	△ 64
フリーCF	△ 35	+ 56	△ 55	+ 142	+ 20	+ 71
現金及び現金同等物残高	878	693	607	448	428	438

四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

2Qの研究開発費は計画通り推移し、研究開発費率は7.4%に。





2026年3月期連結業績予想・配当予想

2026年3月第2四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社2QはNAND向け装置販売とアップグレード改造の増加で増収増益。下期からの一部前倒しにより2Q累計では売上・利益とも前回予想を上回って着地。

2026年3月期連結業績予想・配当予想と今後の見通し

- 一部の半導体デバイスメーカーが設備投資の端境期にあったものの、AI関連用途を中心とした高性能デバイスの世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資は今後も続く見通し。
- 当社では、アップグレード改造(サービス)を含めた世界各国DRAM向けの売上が想定以上に好調ながら、下期に想定していた一部装置の販売が27/3期にずれ込む見通しとなり、売上・利益予想を修正。配当予想は据え置き。

2026年3月期業績・配当予想(変更あり)

下期に想定していた一部装置の販売が27/3期にずれ込む見通しとなったことから、前回予想比で売上を6%、調整後営業利益を20%引き下げ。一過性の売上減少が主要因であるため、年間配当金予想は据え置き。

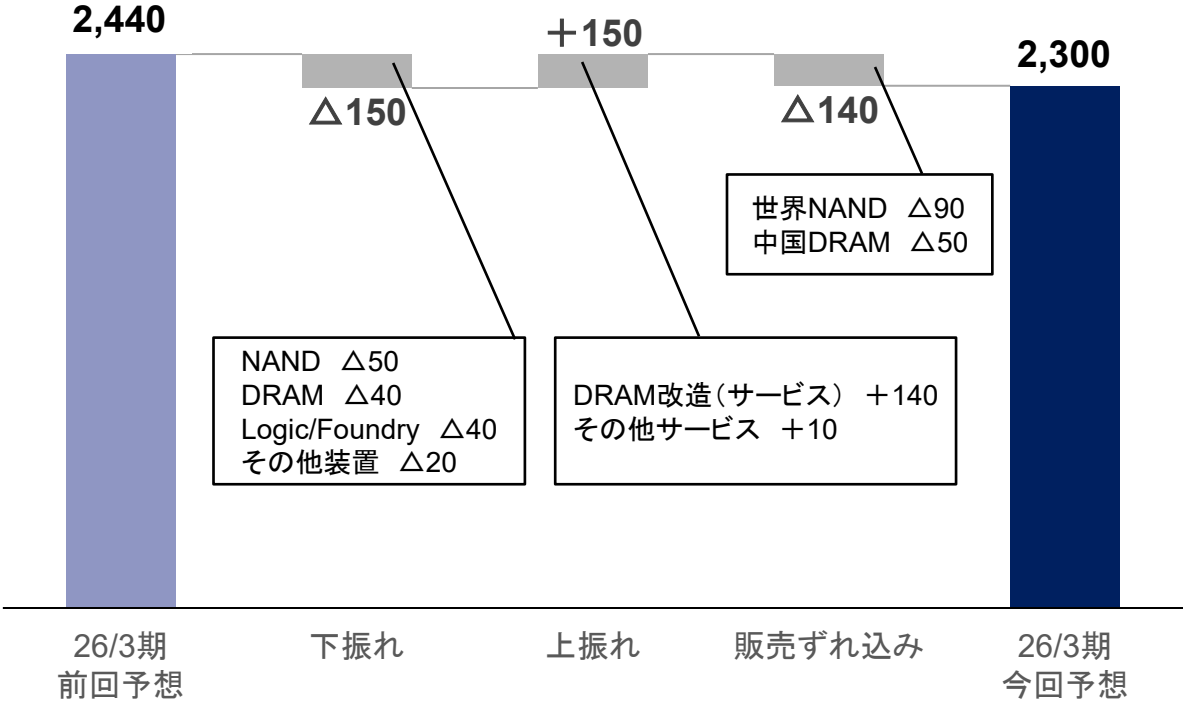
(億円)	25/3期			26/3期					
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期予想	通期今回予想	前期比	通期前回予想比	通期前回予想
売上収益	1,145	1,244	2,389	1,172	1,128	2,300	△3.7%	△5.7%	2,440
売上総利益	514	504	1,017	495	440	935	△8.1%	△10.5%	1,044
売上総利益率	44.8%	40.5%	42.6%	42.2%	39.0%	40.7%	△1.9pts	△2.1pts	42.8%
調整後営業利益	307	271	578	253	191	444	△23.1%	△19.6%	552
調整後営業利益率	26.8%	21.8%	24.2%	21.6%	17.0%	19.3%	△4.8pts	△3.3pts	22.6%
調整後当期(半期)利益	216	207	423	174	144	318	△24.8%	△20.7%	401
調整後当期(半期)利益率	18.9%	16.6%	17.7%	14.8%	12.8%	13.8%	△3.9pts	△2.6pts	16.4%
営業利益	274	239	513	227	161	388	△24.4%	△21.1%	492
営業利益率	24.0%	19.2%	21.5%	19.4%	14.3%	16.9%	△4.6pts	△3.3pts	20.2%
税引前当期(半期)利益	279	228	508	222	154	376	△26.0%	△22.3%	484
税引前当期(半期)利益率	24.4%	18.4%	21.3%	18.9%	13.7%	16.3%	△5.0pts	△3.5pts	19.8%
当期(半期)利益	181	180	360	156	123	279	△22.5%	△22.5%	360
当期(半期)利益率	15.8%	14.4%	15.1%	13.3%	10.9%	12.1%	△3.0pts	△2.6pts	14.7%
1株当たり配当金(円)	18	19	37	18	18	36	△1円	0	36
配当性向(調整後当期利益ベース)	—	—	20.4%	—	—	26.4%	+6.0pts	+5.5pts	20.9%

2026年3月期業績予想 増減要因(変更あり)

- 世界各国NAND向け、中国地場DRAM向け装置販売の27/3期へのずれ込みにより、売上予想を引き下げ。
- NAND向けとLogic/Foundry向けの下振れを、DRAM向けアップグレード改造の上振れが吸収。
- 販売等の減少、生産台数の減少、製品構成の変化による売上総利益の減少により、調整後営業利益予想を引き下げ。

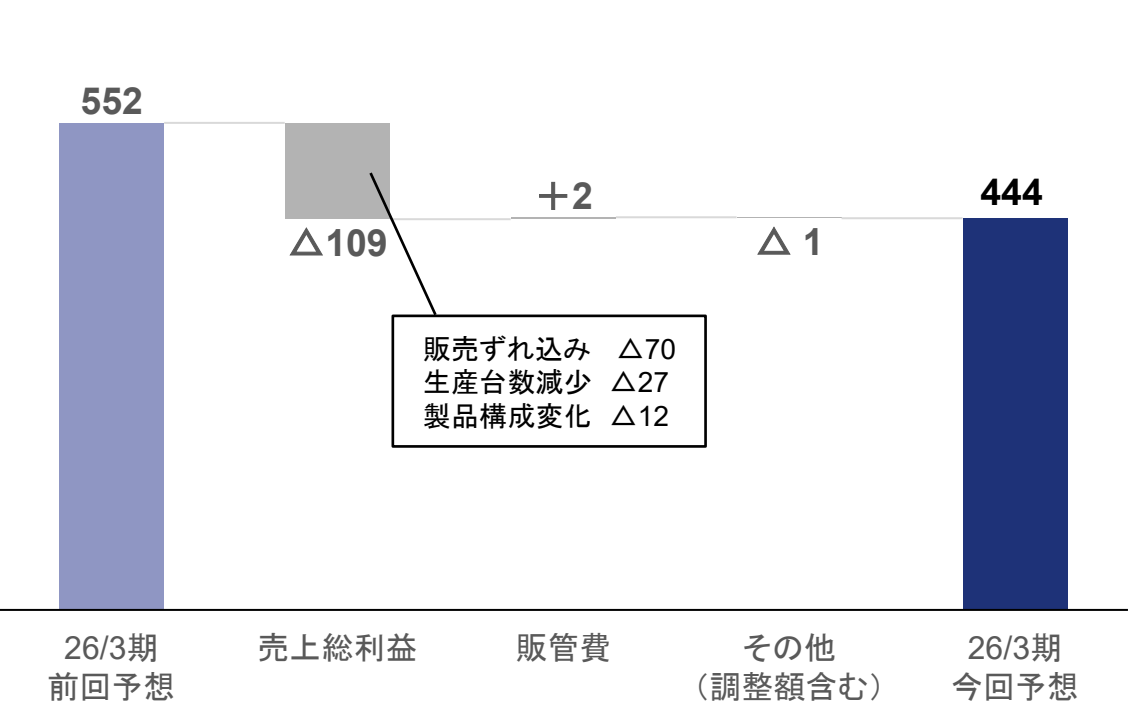
売上収益

(億円)



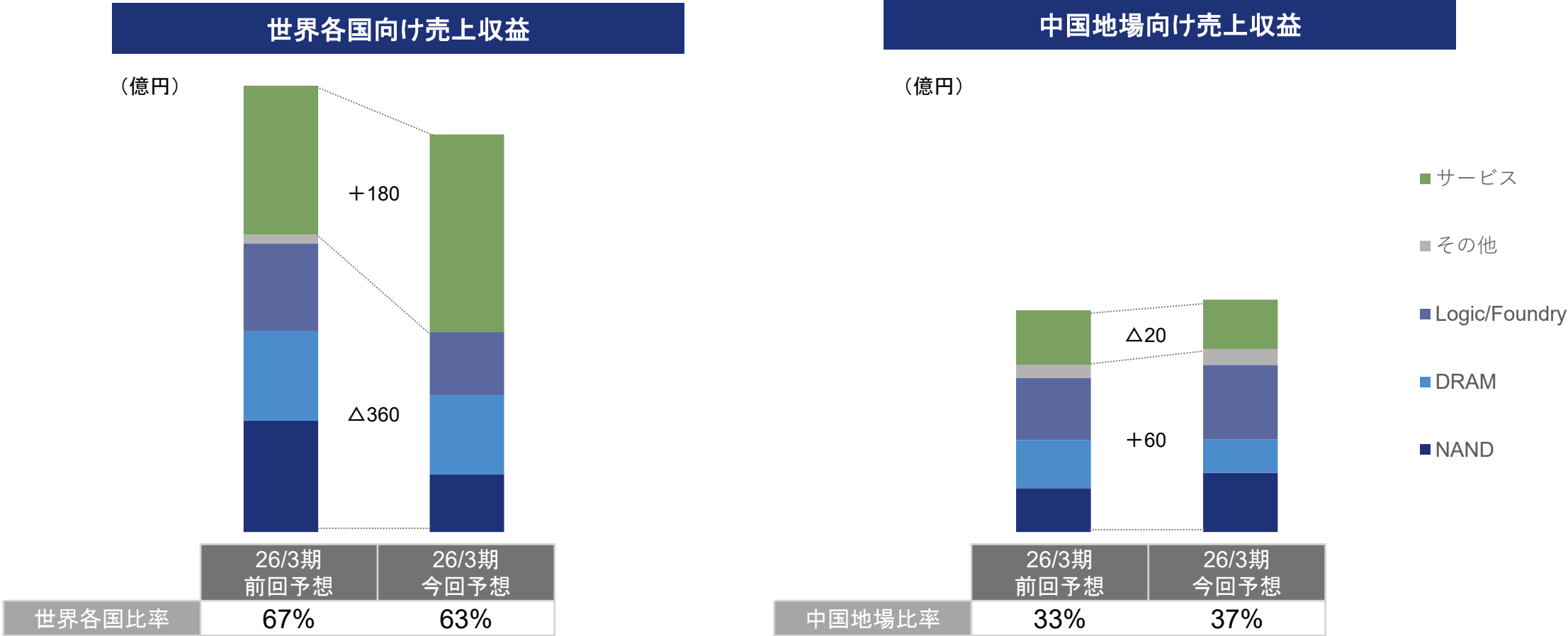
調整後営業利益

(億円)



2026年3月期業績予想 アカウント別*1売上収益(変更あり)

- 世界各国向け売上は前回予想比△180億円。NAND向け、Logic/Foundry向けを引き下げ。DRAM向けは引き下げもアップグレード改造を中心にサービスを引き上げ。
- 中国地場向け売上は前回予想比+40億円。NAND向け、Logic/Foundry向けを引き上げ。DRAM向けは販売ずれ込みで引き下げ。中国地場売上比率は37%を予想。



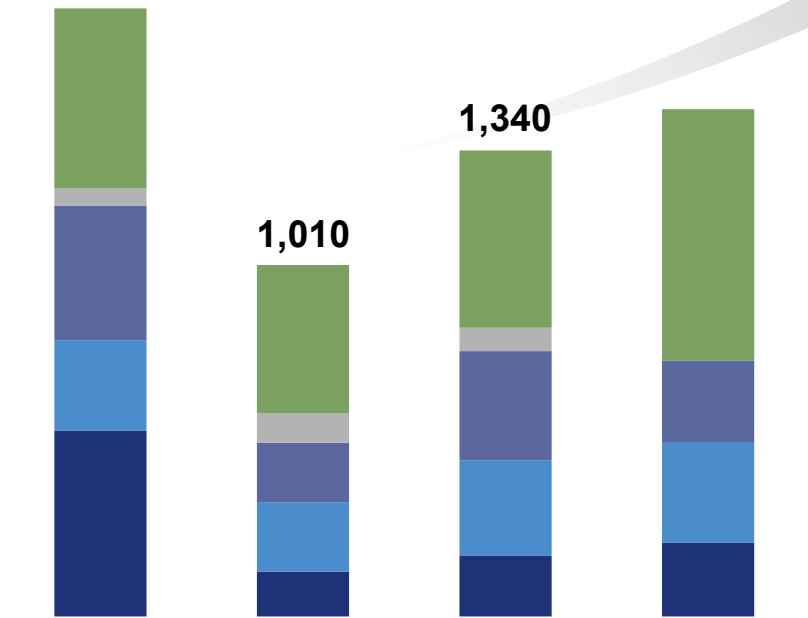
*1 世界各国デバイスメーカー(中国以外に本拠のあるメーカー)向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

2026年3月期業績予想 アカウント別*1売上収益(変更あり)

- 世界各国向け売上は、NAND、DRAM向けの販売増加とサービスの伸長により前期比9%増加を予想。
Logic/Foundry向けは成熟ノードが低調ながらGAA関連は伸長。
- 中国地場向け売上は、投資端境期におけるDRAM向けの販売減少により前期比20%減少を予想。
NAND、Logic/Foundry向けの販売は伸長。

世界各国向け売上収益

(億円) 1,748



世界各国比率

71%

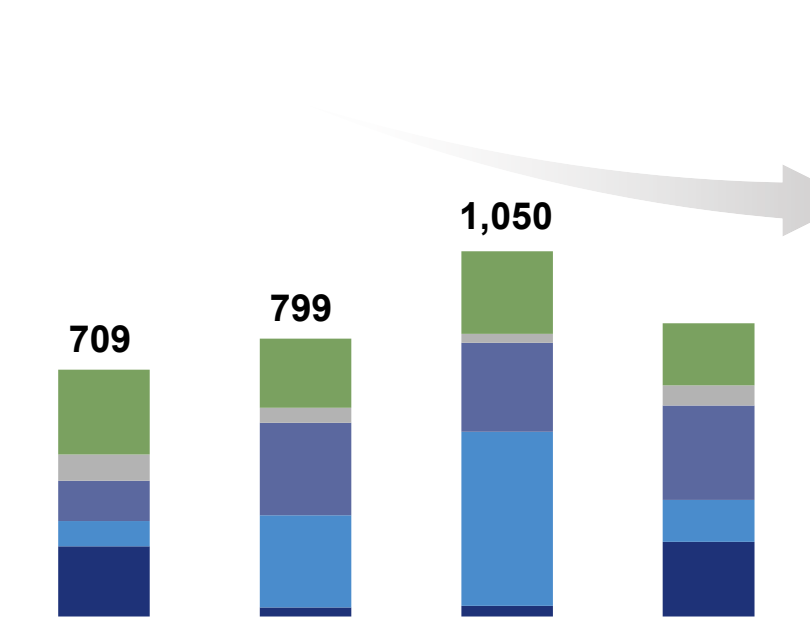
56%

56%

63%

中国地場向け売上収益

(億円)



中国地場比率

29%

44%

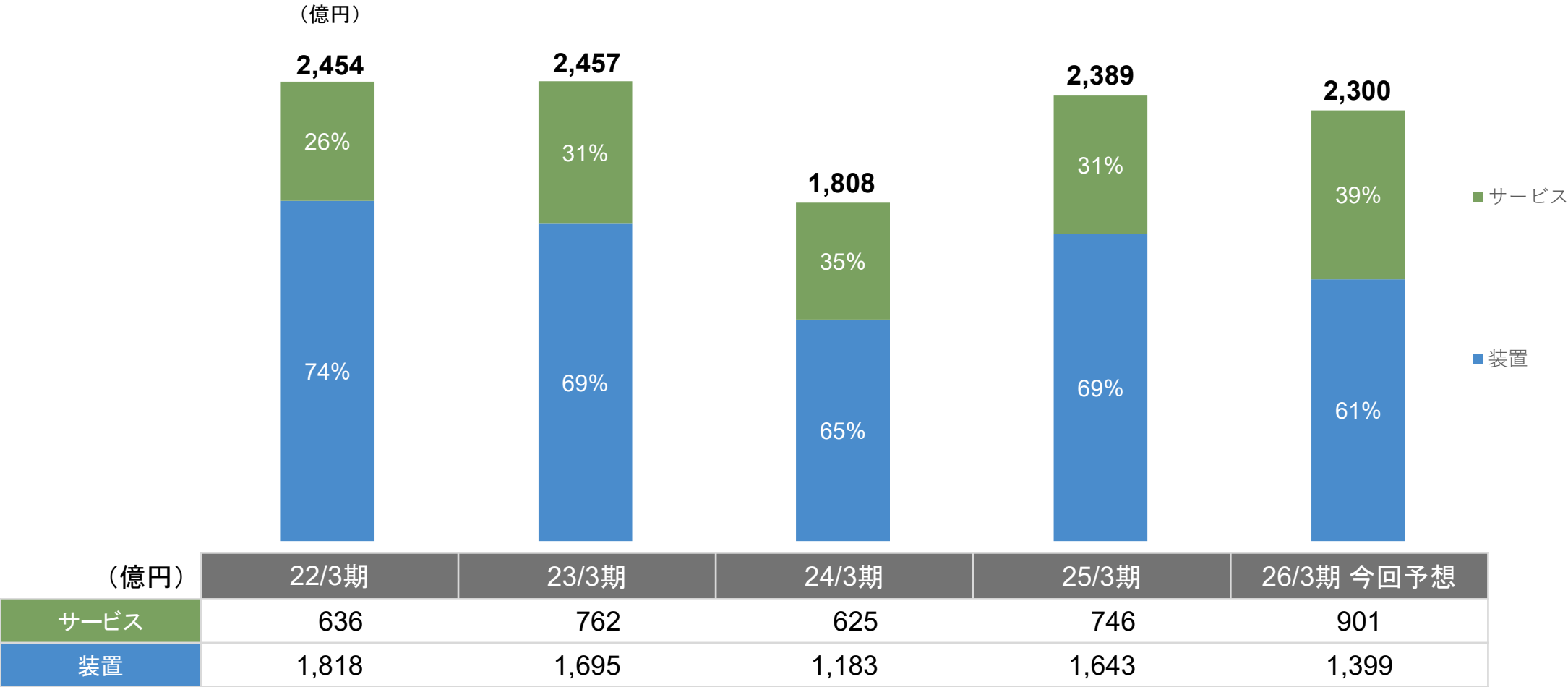
44%

37%

■ サービス
■ その他
■ Logic/Foundry
■ DRAM
■ NAND

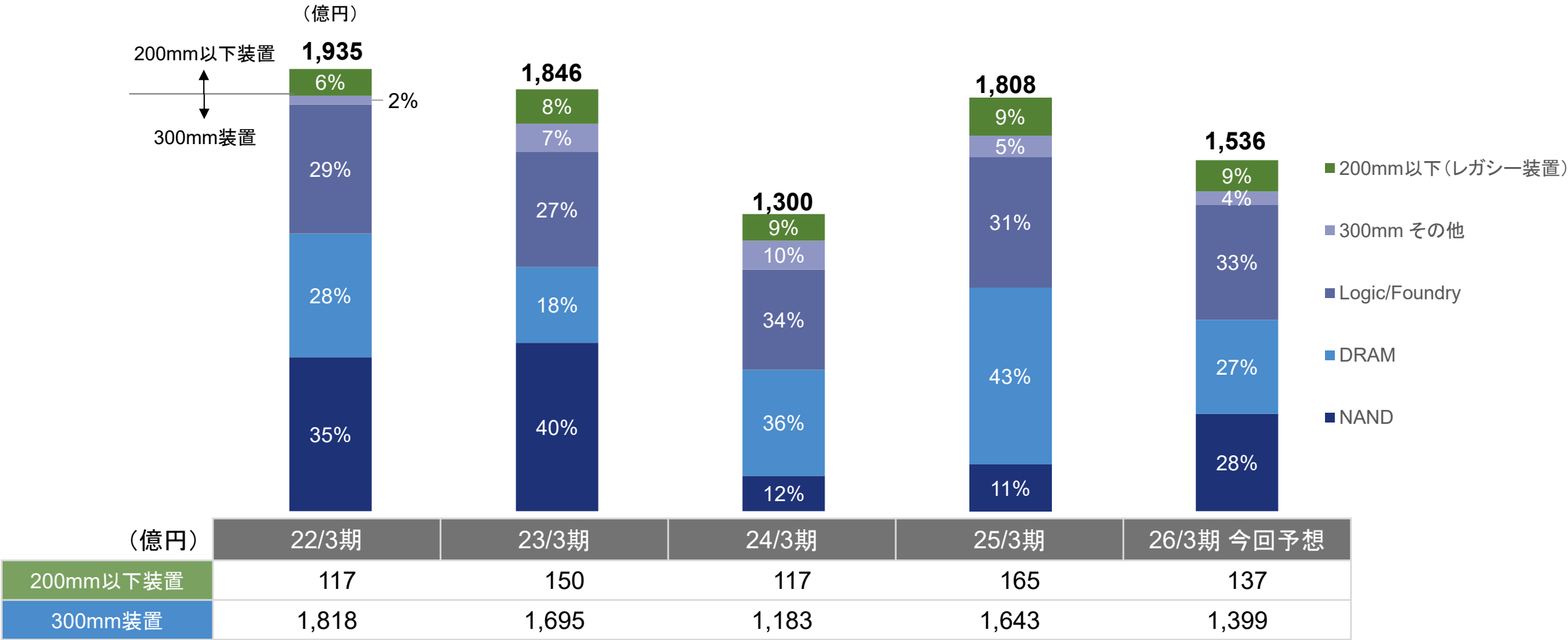
2026年3月期業績予想　ビジネス別売上収益(変更あり)

新規装置販売に代えてアップグレード改造(サービス)が増加した影響により、装置売上は前期比15%減、サービス売上は20%増を予想。売上構成比は装置売上比率が61%に低下する予想。



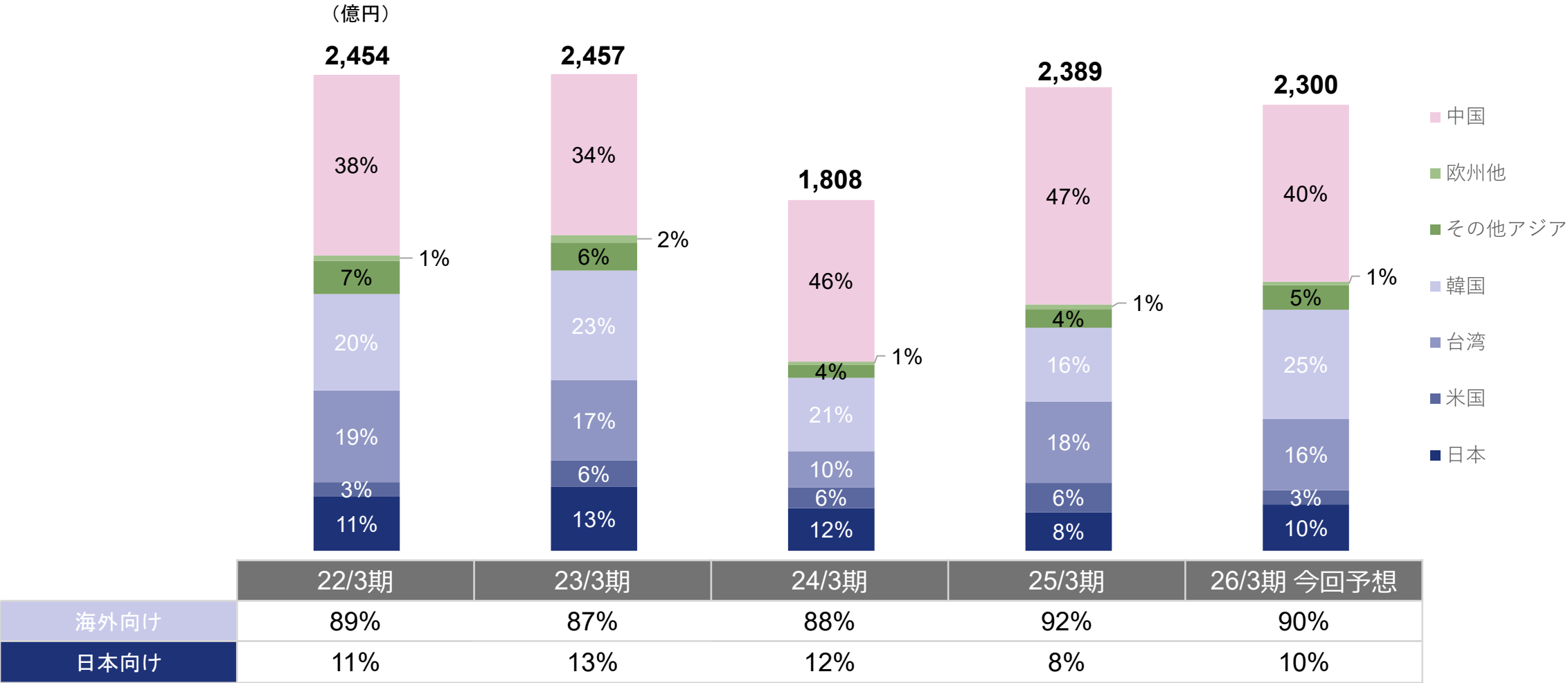
2026年3月期業績予想 アプリケーション別売上収益*1(変更あり)

前期比でNAND向けは2倍に増加、DRAM向けは47%減(アップグレード改造を含まず)、Logic/Foundry向けは11%減を予想。SiC/GaNパワーデバイス向けは前期並みを予想。



2026年3月期業績予想 仕向地別売上収益(変更あり)

前期比で日本、韓国、その他アジア向け売上比率は増加、中国、米国、台湾向け売上比率は減少を予想。
米国向け売上比率は3%にとどまる見通し。

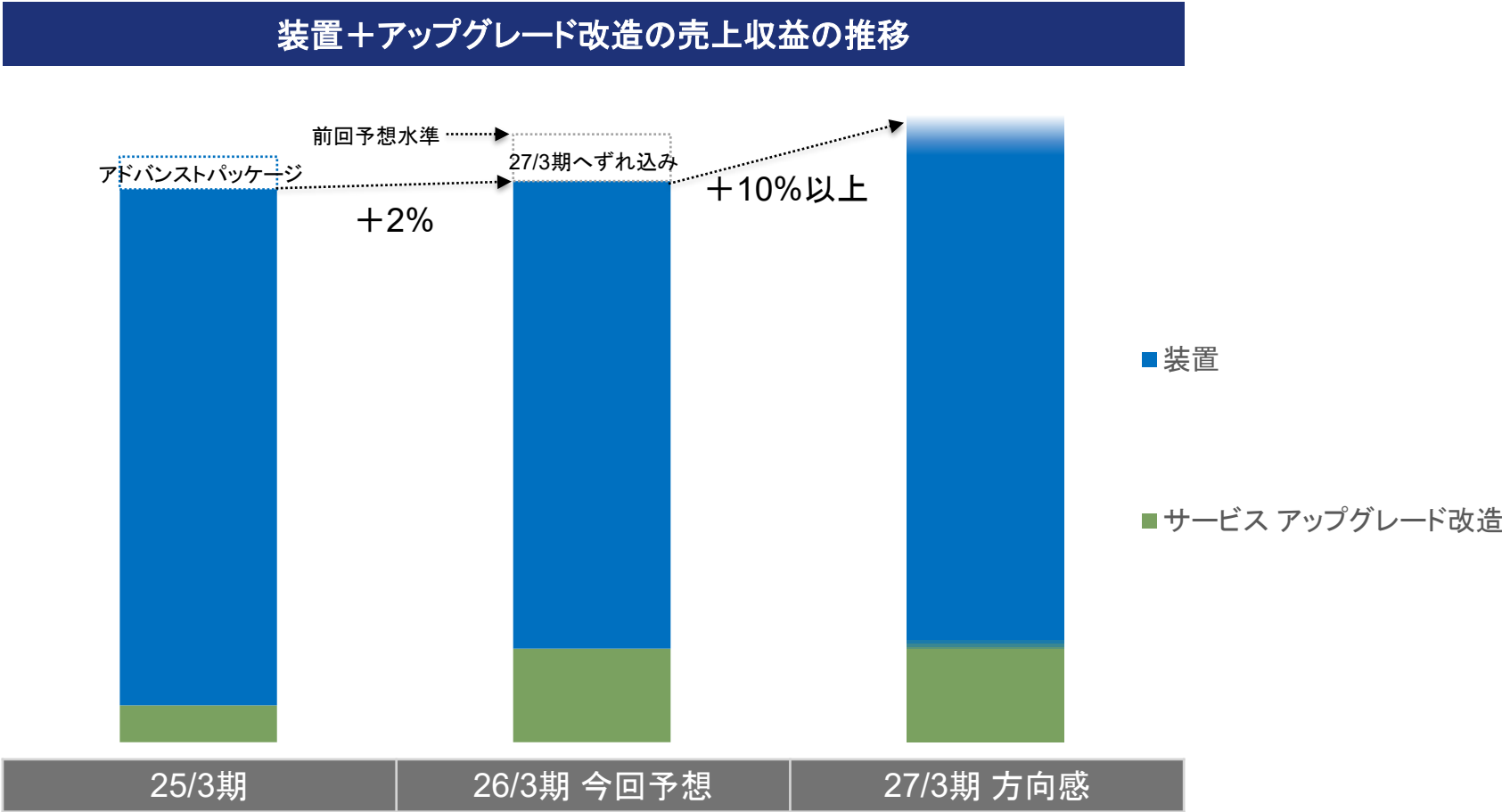




今後の見通し

2027年3月期の方向感

CY25のWFEは前年比微増を予想、CY26のWFEは前年比5%程度の成長を想定。
26/3期から27/3期へのずれ込み分を含め、27/3期の装置＋アップグレード改造売上で前期比10%以上の増収をめざす。



事業環境の見通し

生成AI関連の需要が引き続きデバイスメーカーの設備投資をけん引すると予想。
長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。

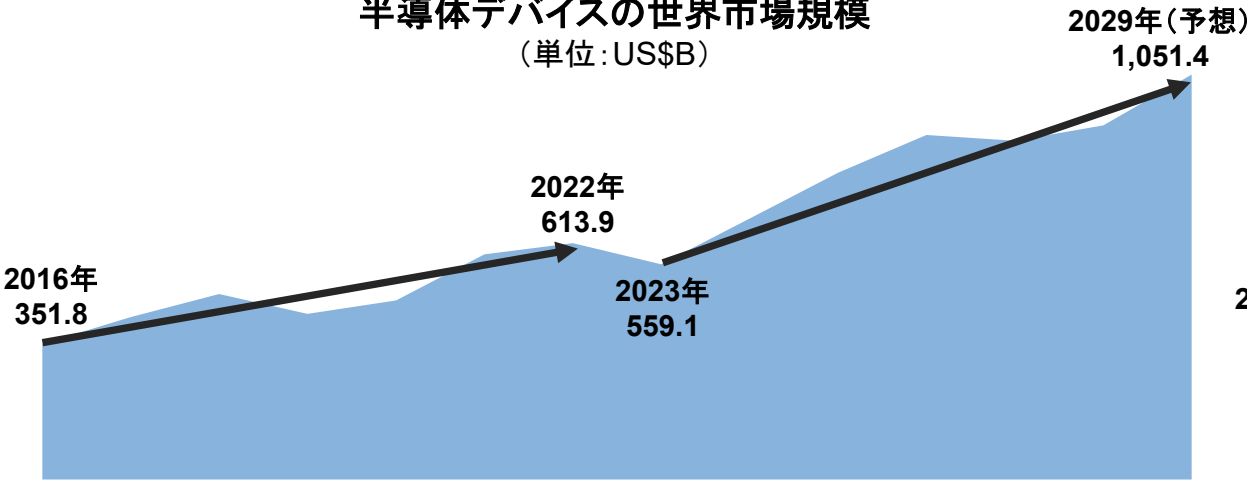
半導体デバイス市場

- 半導体デバイス市場では、生成AI関連の需要が引き続きデバイスメーカーの設備投資をけん引。メモリー需要にはさらなる拡大の兆しあり。
- 成熟ノード向けの設備投資は中国で相応の規模が持続するものの、欧米他では投資抑制が続く。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、グリーントランスフォーメーションへの投資等により、大きな成長が期待される。

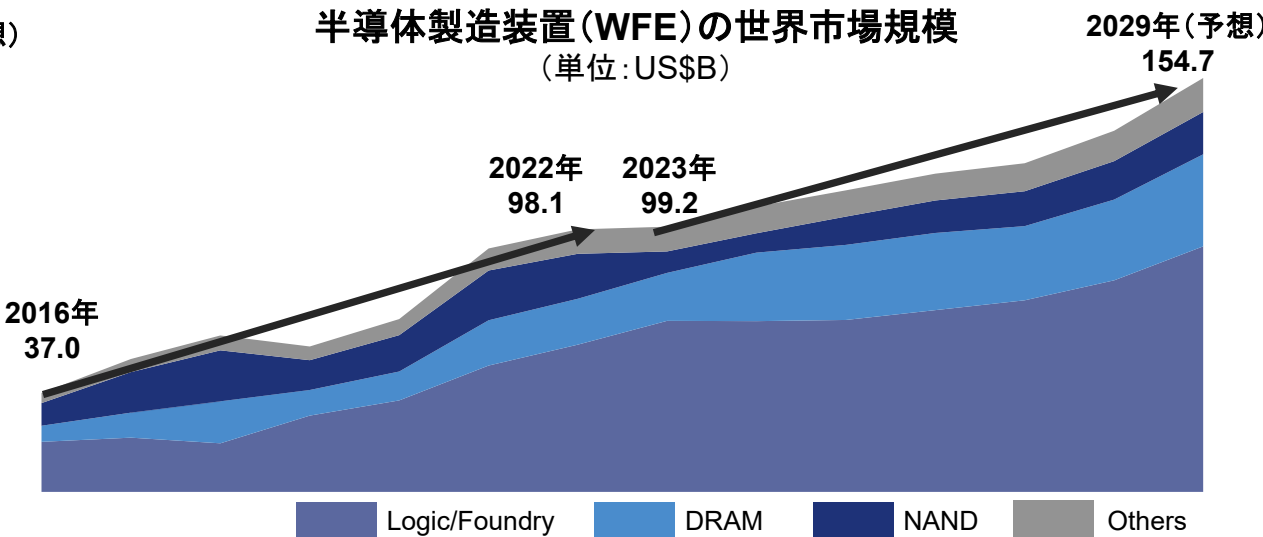
半導体製造装置(WFE)市場

- 高性能デバイス向け装置需要が増加基調を持続。成熟ノード向け装置需要は中国で一定規模を持続も欧米他では停滞。
- WFEのCY25規模は前年比微増を予想。CY26は前年比+5%程度の拡大を想定。
- 中長期的には大きな成長が期待され、今後数年で1,200億ドル程度まで成長するとの想定には変更なし。

半導体デバイスの世界市場規模
(単位:US\$B)



半導体製造装置(WFE)の世界市場規模
(単位:US\$B)



出所: Techinsights Inc. "Long-Term Semiconductor, Silicon, and Equipment Forecast" (Oct-2025)
Techinsights Inc-WAFER FAB EQUIPMENT BY CUSTOMER TYPE (2019 - 2030)_Sep-25

アプリケーション別の事業環境と当社の状況

AI関連で高性能DRAM、Logic/Foundry向けが引き続き好調、NAND向けは世代交代投資で回復も、装置需要の一部が27/3期にシフトする見通し。成熟ノードLogic/Foundryの回復は緩やか。

下線は、第1四半期決算発表時点からの主な変更箇所です。

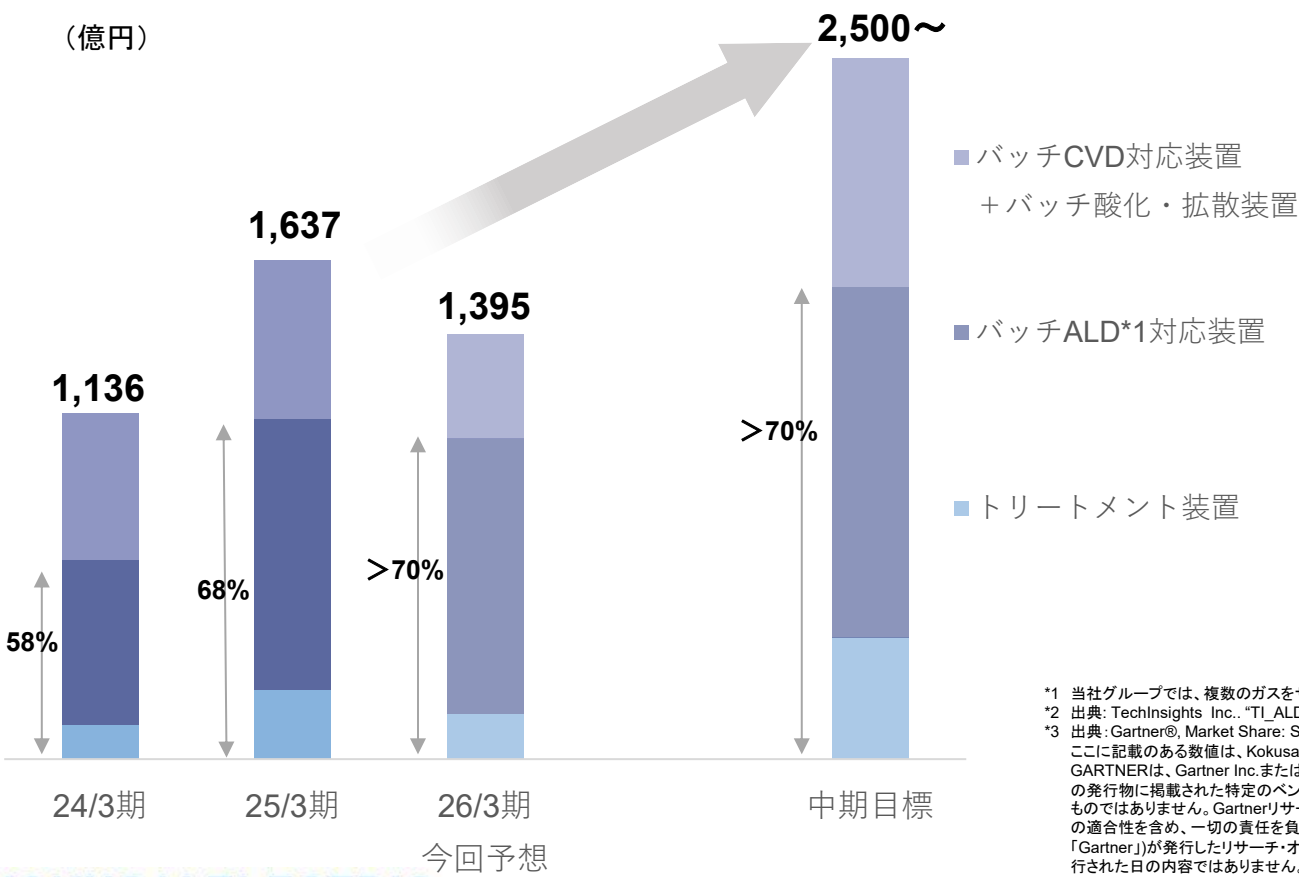
	事業環境	当社
NAND	- 世界各国向けでデバイス世代交代に向けた装置需要が増加。<u>AI関連で需要増加の兆し。</u> - 中国地場向けでも3期ぶりに装置需要が増加。	- 世界各国向けは、デバイス世代交代投資により装置販売が増加。<u>一部需要は来期にシフト。</u> - 中国地場向けは世代交代と生産規模拡大に向けた投資により<u>想定以上に装置販売が増加。</u>
DRAM	- AI関連の普及・拡大に伴って高性能デバイスの世代交代と生産規模拡大に向けた装置需要が増加。 - 中国大手メーカーの投資端境期にあたる26/3期前半は需要減少、後半から回復も米中貿易摩擦の間接影響を注視。	- デバイス世代交代と生産規模拡大等に向けた装置需要・アップグレード改造が増加。新規PORが収益に寄与、次世代でもPOR拡大をめざす。 - 中国向けは下期から回復。<u>一部の装置販売が来期にシフト。</u>
Logic/Foundry	- 大手デバイスメーカーの積極投資により、先端ノード向け装置需要が増加。 - 中国地場成熟ノード向け装置需要は相応の規模が持続、欧米他成熟ノード向け装置需要は投資抑制が続く。	- GAA第1世代向けは装置販売が増加。<u>米国での新規投資に期待。インターポーザー向けは端境期へ。</u> - 欧米他成熟ノード向けはシェア拡大に向けた取り組みを継続し、需要回復に備える。
SiC/GaNパワーデバイス (サービスビジネス)	- 世界各国では需要停滞、<u>中国地場でも需要に減速感。</u> - ウェーハサイズが150mmから200mmに移行するのに合わせて需要拡大に期待。	<u>既存製品の売上は堅調。</u>200mm化およびトレンチゲート化に伴う高温活性化アニール等新製品への需要シフトを捉えて成長をめざす。 - ALD^{*1}関連の新たなソリューション開発にも注力。

^{*1} 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

製品構成の現状と見通し(変更あり)

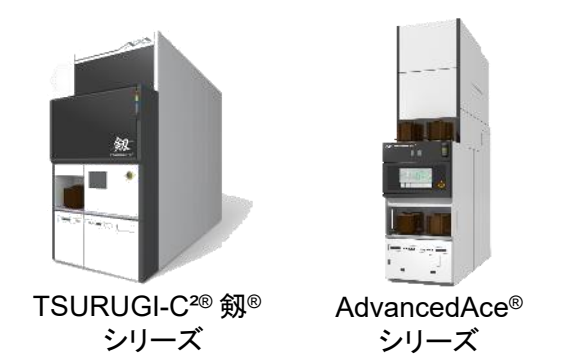
デバイスの世代交代に伴い、高付加価値製品の構成比が拡大。特に付加価値の高いミニバッチ装置の販売拡大が中国地場向け売上比率の低下による影響を吸収する見通し。

装置売上(サービス売上含まず)



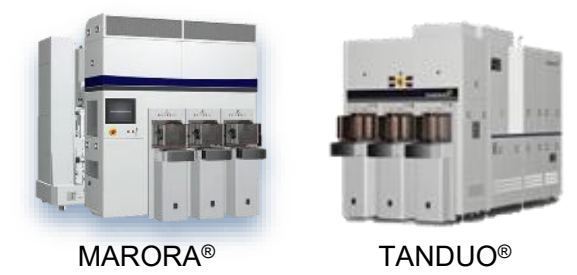
バッチ処理装置

- バッチALD*1対応装置
世界シェア No.1 (2024年)*2
- バッチCVD対応装置
- バッチ酸化・拡散装置



トリートメント装置

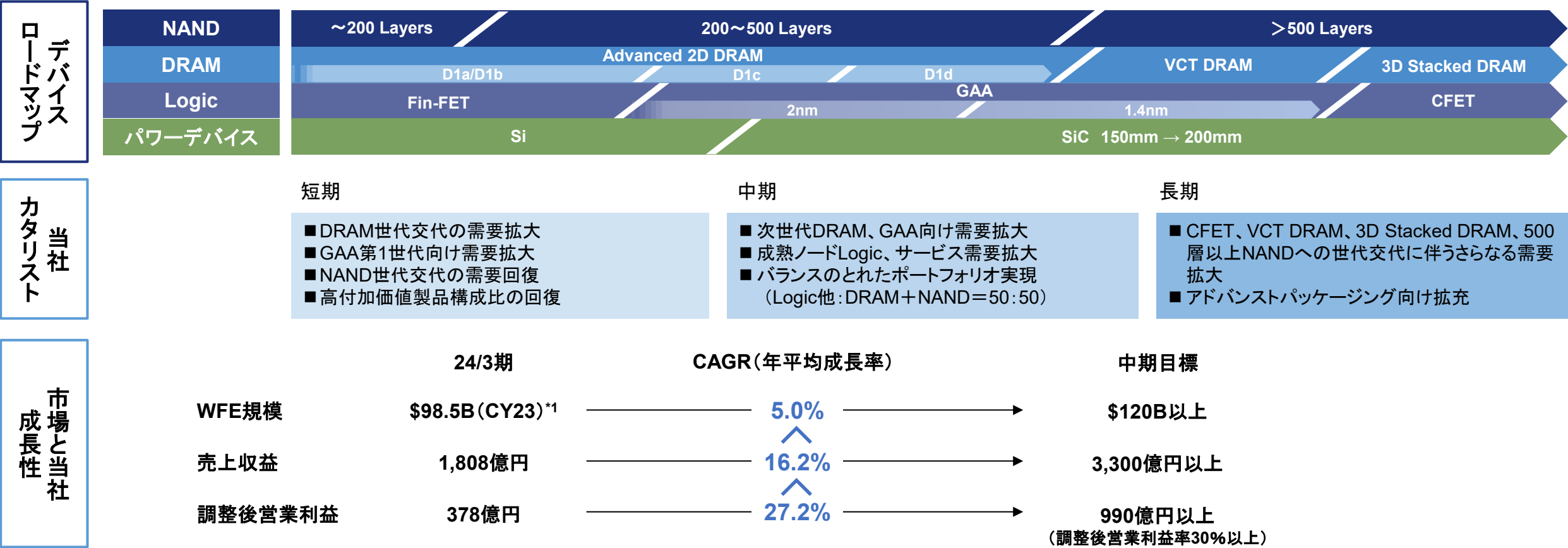
- Plasma Gate Modification Tools
世界シェア No.1 (2024年)*3
- Others



*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
*2 出典: TechInsights Inc.. "TI_ALD Tools_YEARLY" (April 2025)
*3 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al, Published 21 April 2025
ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。トリートメント装置: RTP and Oxidation/Diffusion。
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

まとめ(5月13日公表)

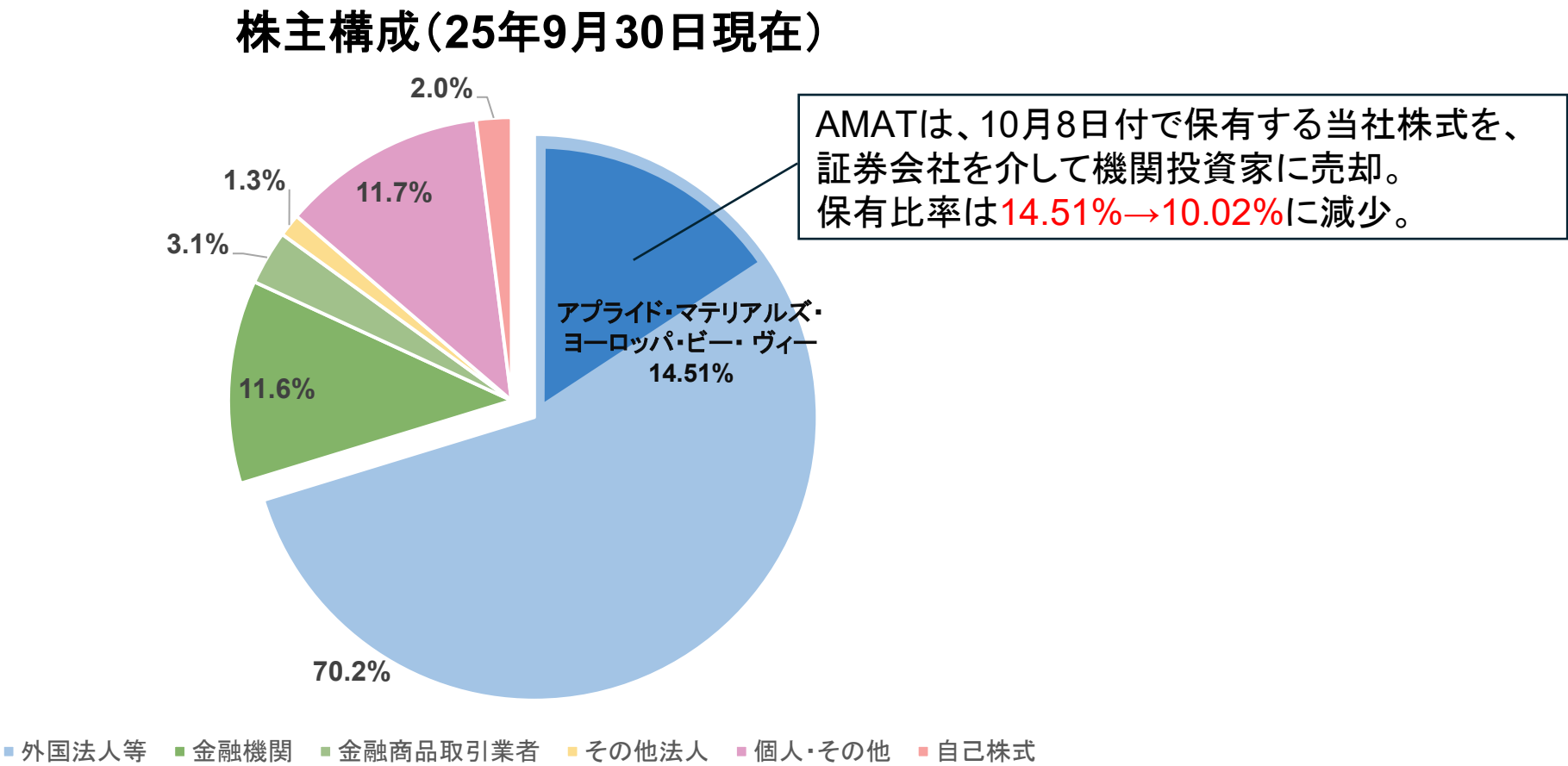
半導体デバイスの進化に伴う微細化・複雑化・三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして市場成長を上回る事業拡大をめざす。



*1 出所: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)

AMATの当社保有株式一部売却について

AMATが当社株式の一部を機関投資家に売却し、AMATの保有比率は10%に低下。



2026年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告 経営・事業活動

経営・事業活動

- ASMPと半導体パッケージ技術に関する共同開発契約を締結。(25/9)
- ロームから2025年度「優秀サプライヤー賞」を受賞。(25/9)
- 「SEMICON® Taiwan 2025」に出展。(25/9)
- 「SSDM2025」で当社従業員が口頭発表。(25/9)
- 横浜国立大学との共同研究により次世代3D半導体デバイスの省エネルギー化に貢献する新規膜とその接合プロセスを実証。(25/6)
- 「SEMICON® Southeast Asia 2025」に出展。(25/5)
- 「MEMS Engineer FORUM 2025」に出展。(25/4)



「SEMICON® Taiwan 2025」当社グループの展示ブース



「FAB EQUIPMENT」「WFE TO SPECIALTY CHIP MAKERS」の
両部門において、トップ10にランクイン

2026年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告 ESGの取り組み

ESGの取り組み

- 富山市八尾町で開催された「おわら風の盆」に協賛。(25/9)
- CDP2024「サプライヤー・エンゲージメント評価」で最高評価を獲得。(25/7)
- 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定。(25/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査「Global Semiconductor Supplier Awards」で「Top 10 Customer Service」を28年連続で受賞。(25/5)
- 保育所施設で青空環境教室を実施。(25/5)
- 100%再生可能エネルギーの使用をめざす国際イニシアティブ「RE100」に参画。(25/4)
- 富山事業所で「とやま水の郷でんき」の使用量を全体の35%に引き上げ。(25/4)
- 富山県砺波市で開催される「2025となみチューリップフェア」に協賛。(25/4)
- 富山マラソン2025にゴールドパートナーとしての協賛を決定。(25/4)

©(公社)とやま観光推進機構



おわら風の盆に協賛



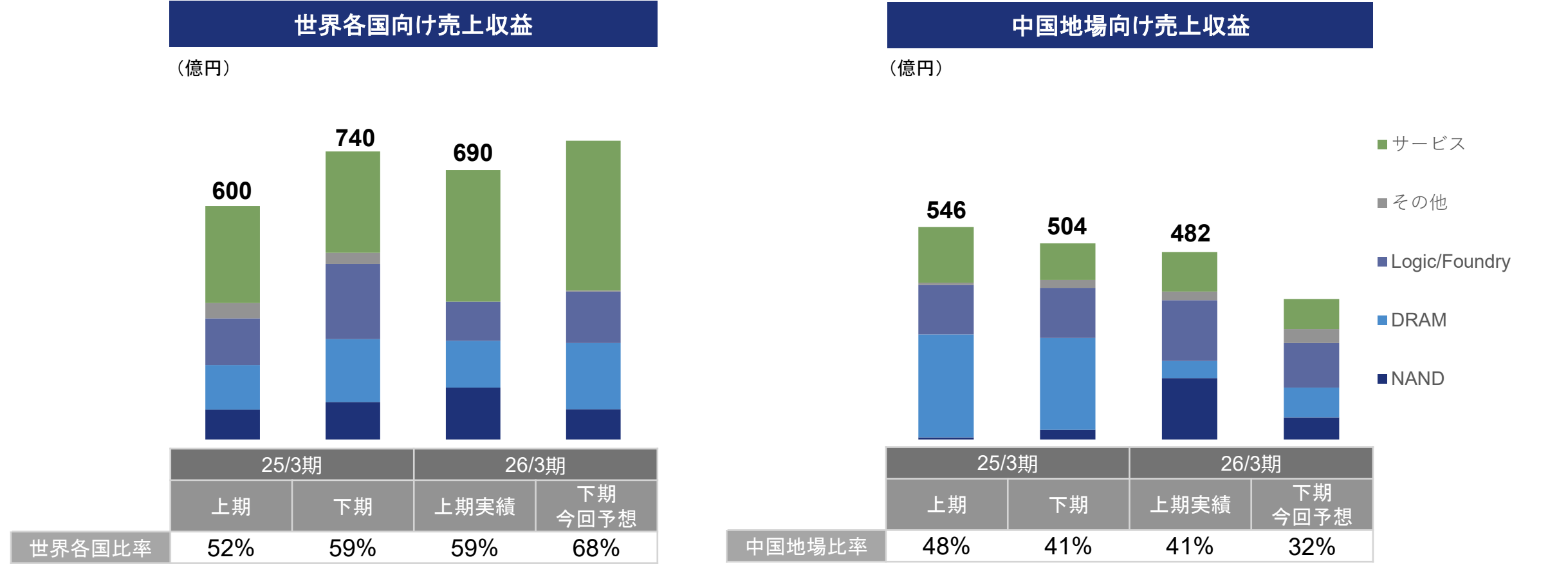
CDP2024で
サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定



Appendix

2026年3月期業績予想 上期・下期別売上収益 アカウント別*1(変更あり)

世界各国向けは、装置販売の一部が下期から27/3期にずれ込むものの、売上増加基調が継続。
中国地場向けは、装置販売の一部が下期から上期へ、一部が下期から27/3期へずれ込む影響で売上減少傾向が続くものの、26/3期が底となる見通し。



損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	25/3期						26/3期		
	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	2Q累計
売上収益	65,224	49,324	114,548	60,117	64,268	238,933	51,789	65,416	117,205
売上総利益	29,354	22,012	51,366	24,865	25,512	101,743	22,220	27,277	49,497
売上総利益率	45.0%	44.6%	44.8%	41.4%	39.7%	42.6%	42.9%	41.7%	42.2%
調整後営業利益	19,382	11,299	30,681	13,876	13,196	57,753	10,902	14,439	25,341
調整後営業利益率	29.7%	22.9%	26.8%	23.1%	20.5%	24.2%	21.1%	22.1%	21.6%
調整後当期(四半期)利益	14,345	7,262	21,607	9,646	11,050	42,303	7,598	9,785	17,383
調整後当期(四半期)利益率	22.0%	14.7%	18.9%	16.0%	17.2%	17.7%	14.7%	15.0%	14.8%
営業利益	17,878	9,562	27,440	12,274	11,606	51,320	9,717	12,993	22,710
営業利益率	27.4%	19.4%	24.0%	20.4%	18.1%	21.5%	18.8%	19.9%	19.4%
税引前当期(四半期)利益	17,747	10,195	27,942	11,241	11,606	50,789	9,322	12,840	22,162
税引前当期(四半期)利益率	27.2%	20.7%	24.4%	18.7%	18.1%	21.3%	18.0%	19.6%	18.9%
当期(四半期)利益	13,302	4,751	18,053	8,004	9,947	36,004	6,776	8,782	15,558
当期(四半期)利益率	20.4%	9.6%	15.8%	13.3%	15.5%	15.1%	13.1%	13.4%	13.3%
研究開発費	3,348	3,920	7,268	3,755	4,581	15,604	3,851	4,821	8,672
設備投資額	11,215	3,015	14,230	2,494	3,624	20,348	2,302	5,208	7,510
減価償却費	2,914	3,027	5,941	3,328	3,357	12,625	3,417	3,498	6,915

調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	25/3期						26/3期		
	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	2Q累計
営業利益	17,878	9,562	27,440	12,274	11,606	51,320	9,717	12,993	22,710
－その他の収益	△92	△187	△279	△28	△41	△348	△304	△83	△387
＋その他の費用	27	78	105	79	69	253	18	53	71
(調整額)									
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,479	1,477	2,956	1,475	1,476	5,907	1,476	1,476	2,952
＋スタンドアローン関連費用	12	298	310	3	4	317	-	-	-
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	78	71	149	73	82	304	△5	-	△5
調整額 計	1,569	1,846	3,415	1,551	1,562	6,528	1,471	1,476	2,947
調整後営業利益	19,382	11,299	30,681	13,876	13,196	57,753	10,902	14,439	25,341
当期(四半期)利益	13,302	4,751	18,053	8,004	9,947	36,004	6,776	8,782	15,558
－その他の収益	△92	△187	△279	△28	△41	△348	△304	△83	△387
＋その他の費用	27	78	105	79	69	253	18	53	71
(調整額)									
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,479	1,477	2,956	1,475	1,476	5,907	1,476	1,476	2,952
＋スタンドアローン関連費用	12	298	310	3	4	317	-	-	-
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	78	71	149	73	82	304	△5	-	△5
－調整項目に対する税金調整額	△461	△531	△992	△491	△487	△1,970	△363	△443	△806
＋一時的な税金費用の調整額	-	1,305	1,305	531	-	1,836	-	-	-
調整後当期(四半期)利益	14,345	7,262	21,607	9,646	11,050	42,303	7,598	9,785	17,383

貸借対照表及び主要財務指標

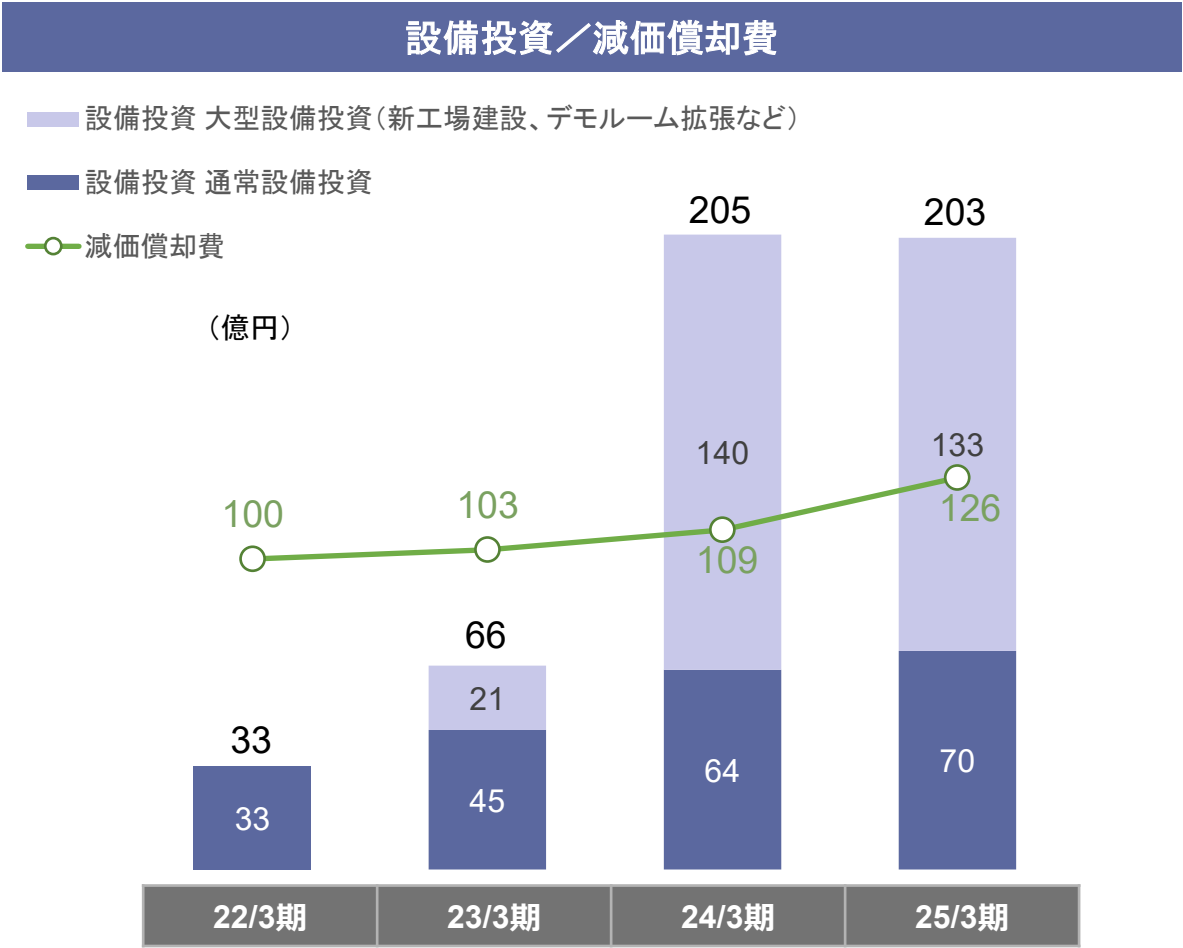
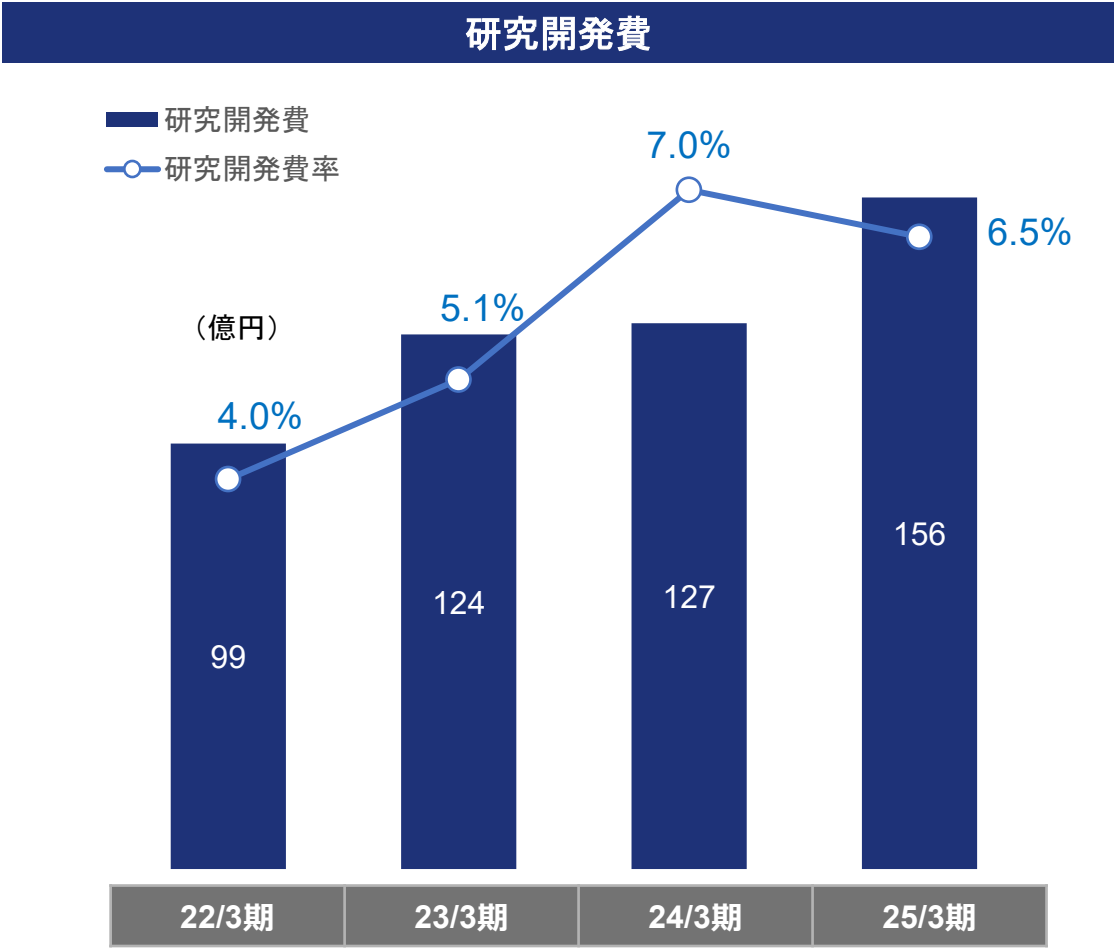
			(百万円)	25/3期				26/3期					(百万円)	25/3期				26/3期	
				1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末					1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末
資産	流動資産	現金及び現金同等物	87,775	69,333	60,722	44,755	42,766	43,806	負債	流動負債	借入金＋リース負債	8,055	8,843	8,843	11,928	11,956	12,044		
		営業債権及びその他の債権	42,444	33,979	42,369	42,835	39,087	38,066			営業債務及びその他の債務	38,657	31,275	30,328	23,606	24,574	25,658		
		棚卸資産	82,028	86,542	91,019	83,200	89,626	89,326			契約負債	19,394	19,734	19,822	22,455	25,069	21,704		
		その他	2,787	1,923	1,923	2,062	2,038	2,065			その他	19,554	22,510	23,180	24,682	17,991	18,687		
		流動資産合計	215,034	191,777	196,033	172,852	173,517	173,263			流動負債合計	85,660	82,362	82,173	82,671	79,590	78,093		
	非流動資産	有形固定資産	45,696	46,714	47,341	46,904	47,220	50,214		非流動負債	借入金＋リース負債	85,555	81,059	80,982	48,256	48,339	42,365		
		のれん	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065			その他	15,199	15,900	15,344	14,417	14,663	14,553		
		無形資産	55,480	54,073	52,652	54,139	53,182	52,013			非流動負債合計	100,754	96,959	96,326	62,673	63,002	56,918		
		その他	10,179	10,609	11,309	8,552	8,524	8,765			負債合計	186,414	179,321	178,499	145,344	142,592	135,011		
		非流動資産合計	170,420	170,461	170,367	168,660	167,991	170,057			資本合計	199,040	182,917	187,901	196,168	198,916	208,309		
資産合計			385,454	362,238	366,400	341,512	341,508	343,320	負債及び資本合計			385,454	362,238	366,400	341,512	341,508	343,320		
												25/3期				26/3期			
												1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末		
自己資本比率												51.6%	50.5%	51.3%	57.4%	58.2%	60.7%		
D/Eレシオ												0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3		
ネット・キャッシュ(百万円)												△ 5,835	△ 20,569	△ 29,103	△ 15,429	△ 17,529	△ 10,603		

キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	25/3期						26/3期		
	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	2Q累計
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,073	14,649	18,722	1,936	17,819	38,477	4,923	11,936	16,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,582	△ 9,090	△ 16,672	△ 7,393	△ 3,641	△ 27,706	△ 2,942	△ 4,789	△ 7,731
フリー・キャッシュ・フロー	△ 3,509	5,559	2,050	△ 5,457	14,178	10,771	1,981	7,147	9,128
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,143	△ 22,628	△ 24,771	△ 4,128	△ 29,207	△ 58,106	△ 4,423	△ 6,373	△ 10,796
現金及び現金同等物の期首残高	92,619	87,775	92,619	69,333	60,722	92,619	44,755	42,766	44,755
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,775	69,333	69,333	60,722	44,755	44,755	42,766	43,806	43,806

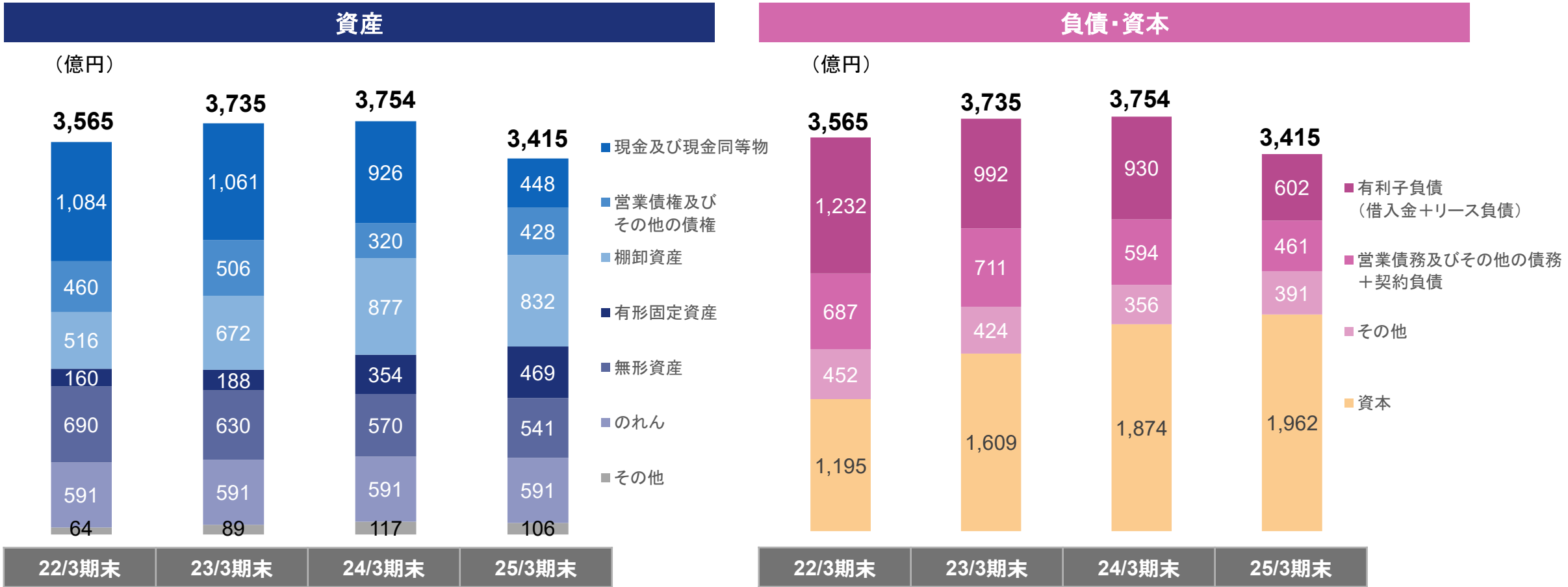
研究開発費／設備投資／減価償却費(5月13日公表)

中長期的な需要拡大を見据え、中計に沿って研究開発投資、設備投資を実施。
研究開発費は前期比2割増。設備投資は2年続いた大型設備投資が完了、減価償却費は前期比2割増。



貸借対照表(5月13日公表)

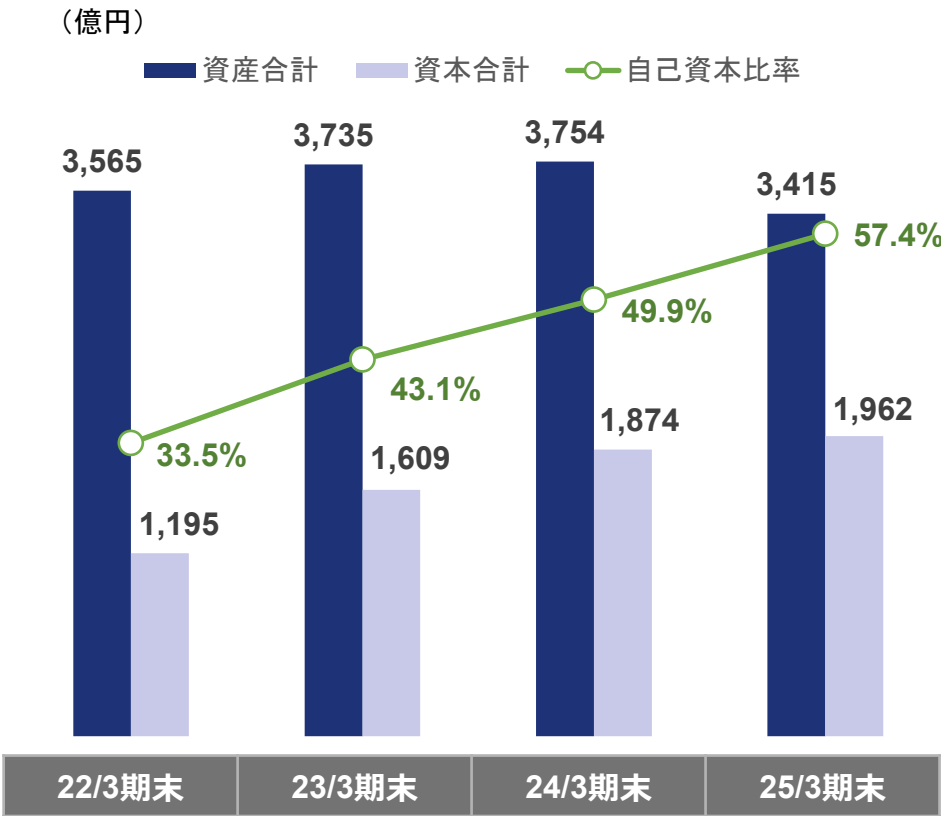
資産合計は、借入金^①の期限前返済、自己株式^②の取得による現金等の減少により、前期末比で339億円減少。
負債合計は、借入金^①の返済、営業債務等の減少により、前期末比で427億円減少。資本合計は利益剰余金の増加等により、前期末比で88億円増加。



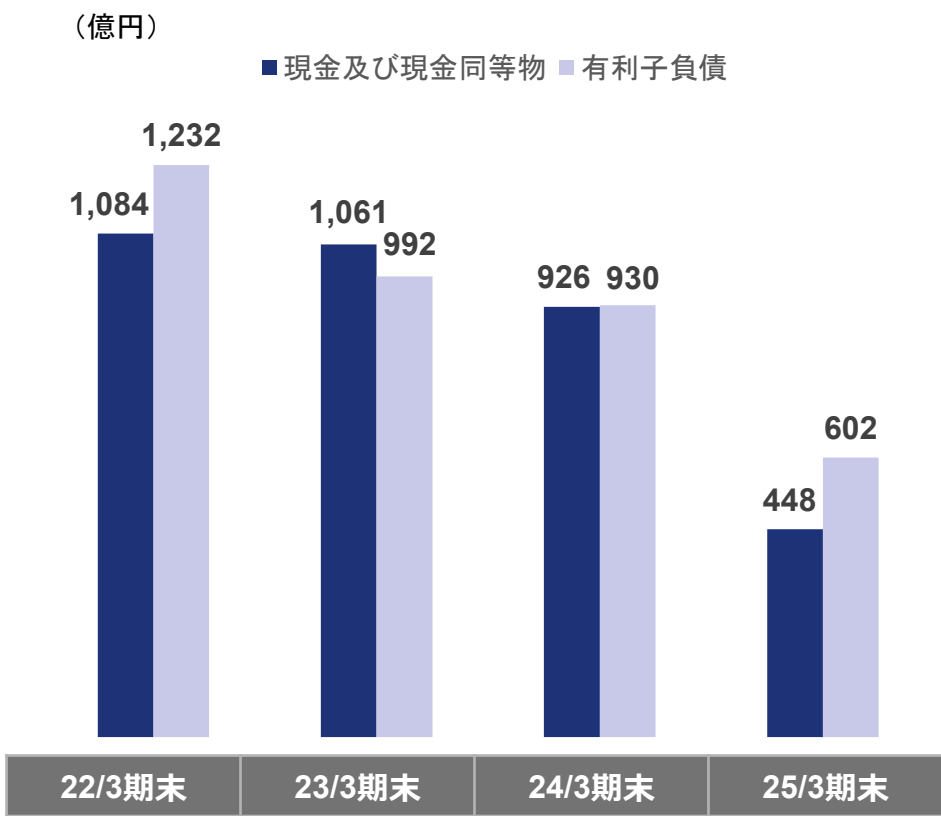
自己資本比率 & 現金及び現金同等物／有利子負債(5月13日公表)

当期末の自己資本比率は57%に上昇。当期末のネットデットは自己株式の取得による現金の支出等で154億円に増加したものの、借入金は期限前返済により333億円減少。

資産合計／資本合計／自己資本比率

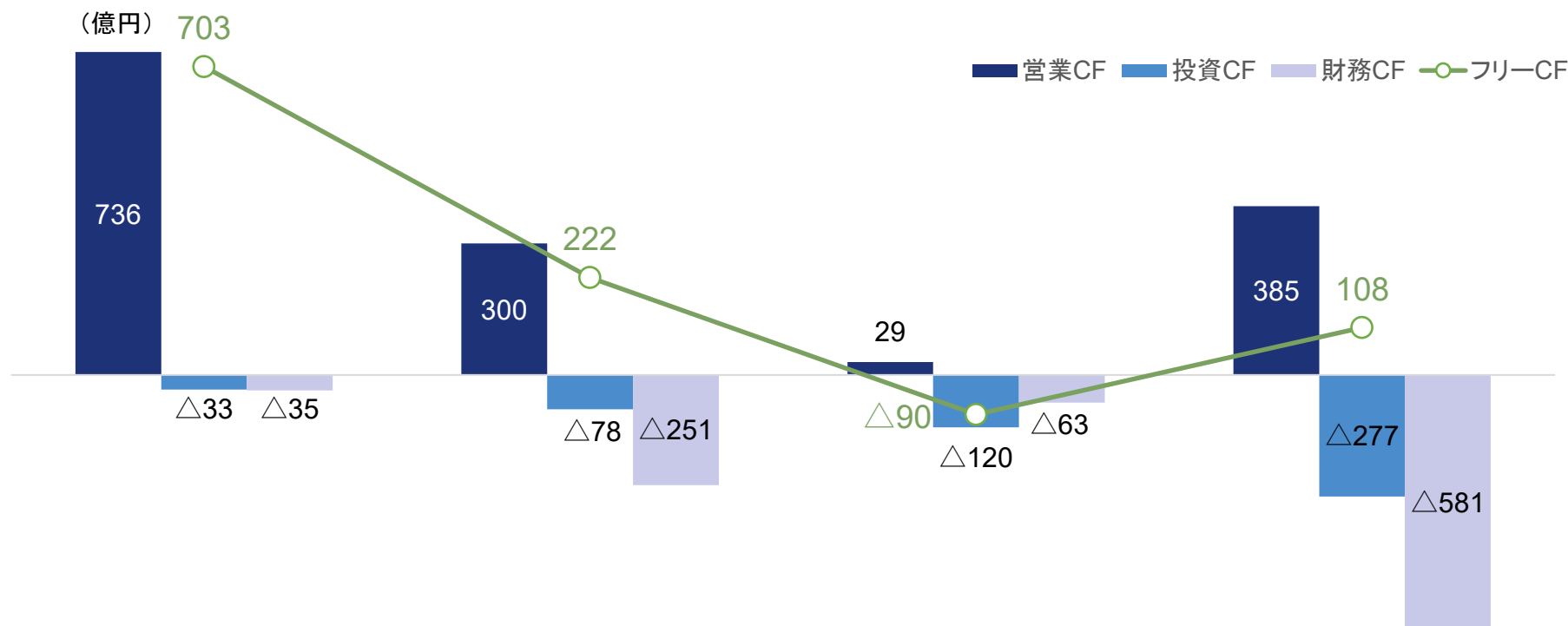


現金及び現金同等物／有利子負債



キャッシュ・フロー(5月13日公表)

売上収益増加による営業CFが有形固定資産取得による投資CFの支出を上回り、フリーCFは108億円。
財務CFは借入金の期限前返済と自己株式の取得による支出等により、581億円の支出。

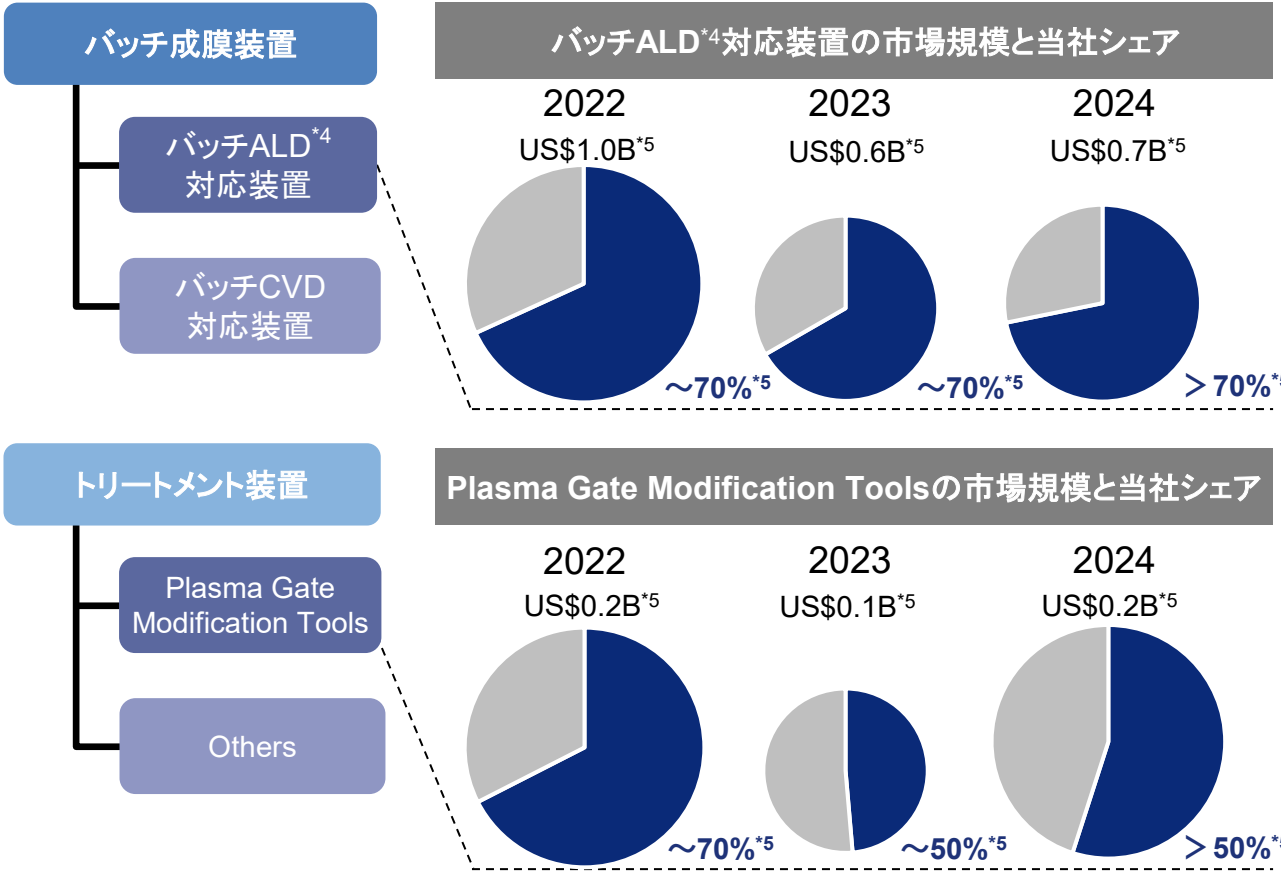
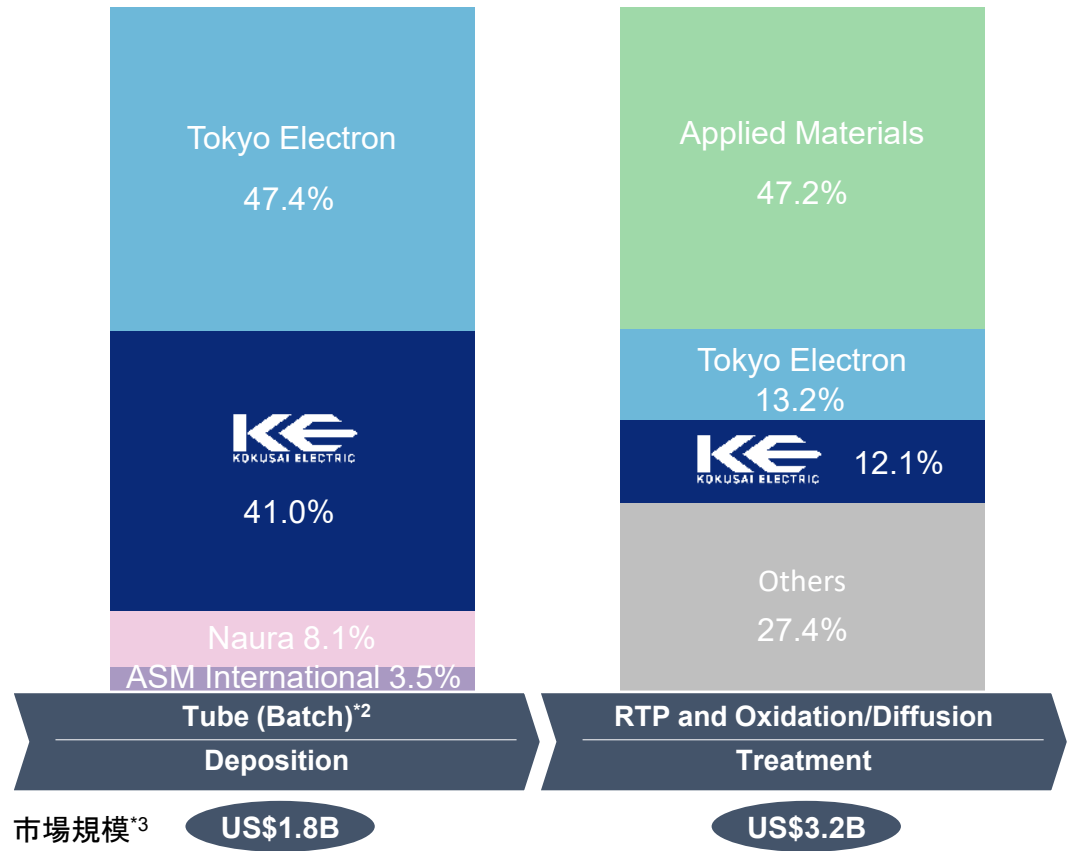


(億円)	22/3期	23/3期	24/3期	25/3期
営業CF	736	300	29	385
投資CF	△33	△78	△120	△277
財務CF	△35	△251	△63	△581
フリーCF	703	222	△90	108
現金及び現金同等物残高	1,084	1,061	926	448

マーケットシェアの推移(5月13日公表)

CY24は、CY23比でバッチ成膜装置、枚葉トリートメント装置ともシェア回復。
バッチALD^{*4}対応装置シェアは70%超で過去最高、枚葉トリートメント装置シェアは50%超に上昇。

(CY24) Gartnerの分類に基づく市場シェア^{*1}



^{*1} 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al. Published 21 April 2025 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。Treatment(トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion。
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。^{*2} GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義(当社にて算出) ^{*3} Gartnerによるカテゴリーの合計値 ^{*4} 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます ^{*5} 公開情報・当社売上高に基づき当社推定

用語集

- バッチ処理装置：多数のウェーハを一括処理する装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE: Wafer Fab Equipmentの略

